

# PCT

## ANTRAG

Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens behandelt wird.

Vom Anmeldeamt auszufüllen

Internationales Aktenzeichen

Internationales Anmeldedatum

Name des Anmeldeamts und "PCT International Application"

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gewünscht)  
(max. 12 Zeichen) T 45172WO/NZ/hs

### Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG

Verfahren zur Erzeugung eines Flächenmusters hoher Auflösung

### Feld Nr. II ANMELDER

☐ Diese Person ist gleichzeitig Erfinder

Name und Anschrift: (Familiennamen, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)

Leonhard Kurz GmbH & Co. KG  
Schwabacher Strasse 482  
DE-90763 Fürth  
Deutschland

Telefonnr.:

Telefaxnr.:

Fernschreibnr.:

Registrierungsnr. des Anmelders beim Amt:

Staatsangehörigkeit (Staat):

DE

Sitz oder Wohnsitz (Staat):

DE

Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten:

☐

alle Bestimmungsstaaten

☒

alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika

☐

nur die Vereinigten Staaten von Amerika

☐

die im Zusatzfeld angegebenen Staaten

### Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER

Name und Anschrift: (Familiennamen, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)

BREHM Ludwig  
Vogtlandstrasse 16  
DE-91325 Adelsdorf  
Deutschland

Diese Person ist:

☐ nur Anmelder

☒ Anmelder und Erfinder

☐ nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)

Registrierungsnr. des Anmelders beim Amt:

Staatsangehörigkeit (Staat):

DE

Sitz oder Wohnsitz (Staat):

DE

Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten:

☐

alle Bestimmungsstaaten

☐

alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika

☒

nur die Vereinigten Staaten von Amerika

☐

die im Zusatzfeld angegebenen Staaten

☒ Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben.

### Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ODER ZUSTELLANSCHRIFT

Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um für den (die) Anmelder vor den zuständigen internationalen Behörden in folgender Eigenschaft zu handeln als:

☒

Anwalt

☐

gemeinsamer Vertreter

Name und Anschrift: (Familiennamen, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.)

ZINSINGER Norbert  
Louis • Pöhlau • Lohrentz  
Postfach 30 55  
DE-90014 Nürnberg  
Deutschland

Telefonnr.:

+49 911 510360

Telefaxnr.:

+49 911 511342

Fernschreibnr.:

Registrierungsnr. des Anwalts beim Amt:

☐ Zustellanschrift: Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und statt dessen im obigen Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist.

## Fortsetzung von Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER

Wird keines der folgenden Felder benutzt, so sollte dieses Blatt dem Antrag nicht beigelegt werden.

Name und Anschrift: (Familiennamen, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)

GEIM Dieter  
Eysölden G9  
DE-91177 Thalmässing  
Deutschland

Diese Person ist:

☐ nur Anmelder

☒ Anmelder und Erfinder

☐ nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)

Registrierungsnr. des Anmelders beim Amt:

Staatsangehörigkeit (Staat):

DE

Sitz oder Wohnsitz (Staat):

DE

Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten:

☐ alle Bestimmungsstaaten

☐ alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika

☒ nur die Vereinigten Staaten von Amerika

☐ die im Zusatzfeld angegebenen Staaten

Name und Anschrift: (Familiennamen, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)

Diese Person ist:

☐ nur Anmelder

☐ Anmelder und Erfinder

☐ nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)

Registrierungsnr. des Anmelders beim Amt:

Staatsangehörigkeit (Staat):

Sitz oder Wohnsitz (Staat):

Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten:

☐ alle Bestimmungsstaaten

☐ alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika

☐ nur die Vereinigten Staaten von Amerika

☐ die im Zusatzfeld angegebenen Staaten

Name und Anschrift: (Familiennamen, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)

Diese Person ist:

☐ nur Anmelder

☐ Anmelder und Erfinder

☐ nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)

Registrierungsnr. des Anmelders beim Amt:

Staatsangehörigkeit (Staat):

Sitz oder Wohnsitz (Staat):

Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten:

☐ alle Bestimmungsstaaten

☐ alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika

☐ nur die Vereinigten Staaten von Amerika

☐ die im Zusatzfeld angegebenen Staaten

Name und Anschrift: (Familiennamen, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)

Diese Person ist:

☐ nur Anmelder

☐ Anmelder und Erfinder

☐ nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)

Registrierungsnr. des Anmelders beim Amt:

Staatsangehörigkeit (Staat):

Sitz oder Wohnsitz (Staat):

Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten:

☐ alle Bestimmungsstaaten

☐ alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika

☐ nur die Vereinigten Staaten von Amerika

☐ die im Zusatzfeld angegebenen Staaten

☐ Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem zusätzlichen Fortsetzungsblatt angegeben.

**Feld Nr. V BESTIMMUNGEN**

Die Einreichung dieses Antrags umfaßt gemäß Regel 4.9 Absatz a die Bestimmung aller Vertragsstaaten, für die der PCT am internationalen Anmeldedatum verbindlich ist, und insoweit verfügbar, für jede Art von Schutzrecht und sowohl für ein regionales als auch für ein nationales Patent.

Dennoch wird

- ☒ DE Deutschland nicht für ein nationales Schutzrecht bestimmt  
☐ KR Republik Korea nicht für ein nationales Schutzrecht bestimmt  
☐ RU Russische Föderation nicht für ein nationales Schutzrecht bestimmt

(Obenstehende Kästchen können angekreuzt werden, um die betreffenden Bestimmungen (unwiderruflich) auszuschließen, um zu vermeiden daß eine frühere nationale Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, nach nationalem Recht ihre Wirkung verliert. Siehe die Anmerkungen zu Feld Nr. V für die Folgen solcher nationalen Rechtsvorschriften in diesen und bestimmten anderen Staaten).

**Feld Nr. VI PRIORITÄTSANSPRUCH**

Die Priorität der folgenden früheren Anmeldung(en) wird hiermit in Anspruch genommen:

Anmeldedatum der früheren Anmeldung (Tag/Monat/Jahr)	Aktenzeichen der früheren Anmeldung	Ist die frühere Anmeldung eine:		
		nationale Anmeldung: Staat oder Mitglied der WTO	regionale Anmeldung:* regionales Amt	internationale Anmeldung: Anmeldeamt
Zeile (1) 21/07/2003 21. Juli 2003	103 33 255.3	DE		
Zeile (2)				
Zeile (3)				

☐ Weitere Prioritätsansprüche sind im Zusatzfeld angegeben.

Das Anmeldeamt wird ersucht, eine beglaubigte Abschrift der oben bezeichneten früheren Anmeldung(en) zu erstellen und dem internationalen Büro zu übermitteln (nur falls die frühere Anmeldung(en) bei dem Amt eingereicht worden ist (sind), das für die Zwecke dieser internationalen Anmeldung Anmeldeamt ist):

☐ sämtliche Zeilen ☒ Zeile (1) ☐ Zeile (2) ☐ Zeile (3) ☐ weitere, siehe Zusatzfeld

\* Falls es sich bei der früheren Anmeldung um eine ARIPO-Anmeldung handelt, geben Sie mindestens einen Staat an, der Mitgliedstaat der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums oder Mitglied der Welthandelsorganisation ist und für den oder das die frühere Anmeldung eingereicht wurde: .....

**Feld Nr. VII INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE**

Wahl der internationalen Recherchenbehörde (ISA) (falls zwei oder mehr als zwei internationale Recherchenbehörden für die Ausführung der internationalen Recherche zuständig sind, geben Sie die von Ihnen gewählte Behörde an; der Zweibuchstaben-Code kann benutzt werden):

ISA /EP .....

Antrag auf Nutzung der Ergebnisse einer früheren Recherche; Bezugnahme auf diese frühere Recherche (falls eine frühere Recherche bei der internationalen Recherchenbehörde beantragt oder von ihr durchgeführt worden ist):

Datum (Tag/Monat/Jahr)

Aktenzeichen

Staat (oder regionales Amt)

**Feld Nr. VIII ERKLÄRUNGEN**

Die Felder Nr. VIII (i) bis (v) enthalten die folgenden Erklärungen (Kreuzen Sie unten die entsprechenden Kästchen an und geben Sie in der rechten Spalte für jede Erklärung deren Anzahl an):

Anzahl der  
Erklärungen

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Feld Nr. VIII (i)   | Erklärung hinsichtlich der Identität des Erfinders   | : |
| <input type="checkbox"/> Feld Nr. VIII (ii)  | Erklärung hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, zum Zeitpunkt des internationalen Anmeldedatums, ein Patent zu beantragen und zu erhalten               | : |
| <input type="checkbox"/> Feld Nr. VIII (iii) | Erklärung hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, zum Zeitpunkt des internationalen Anmeldedatums, die Priorität einer früheren Anmeldung zu beanspruchen | : |
| <input type="checkbox"/> Feld Nr. VIII (iv)  | Erfindererklärung (nur im Hinblick auf die Bestimmung der Vereinigten Staaten von Amerika)   | : |
| <input type="checkbox"/> Feld Nr. VIII (v)   | Erklärung hinsichtlich unschädlicher Offenbarungen oder Ausnahmen von der Neuheitsschädlichkeit  | : |

**Feld Nr. IX KONTROLLISTE; EINREICHUNGSSPRACHE**

Diese internationale Anmeldung enthält:		Dieser internationalen Anmeldung liegen die folgenden Unterlagen bei (kreuzen Sie die entsprechenden Kästchen an und geben Sie in der rechten Spalte jeweils die Anzahl der beiliegenden Exemplare an)	Anzahl
(a) auf Papier, die folgende Anzahl Blätter:		1. <input checked="" type="checkbox"/> Blatt für die Gebührenberechnung	:
Antrag (inklusive Erklärungsblätter)	: 4	2. <input type="checkbox"/> Original einer gesonderten Vollmacht	:
Beschreibung (ohne Sequenzprotokoll und/oder diesbezügliche Tabellen)	: 23	3. <input type="checkbox"/> Original einer allgemeinen Vollmacht	:
Ansprüche	: 6	4. <input checked="" type="checkbox"/> Kopie der allgemeinen Vollmacht; Aktenzeichen (falls vorhanden): 3.1.5, No. 679/89 AV	:
Zusammenfassung	: 1	5. <input type="checkbox"/> Begründung für das Fehlen einer Unterschrift	:
Zeichnungen	: 9	6. <input type="checkbox"/> Prioritätsbeleg(e), in Feld Nr. VI durch folgende Zeilennummer(n) gekennzeichnet:	:
<b>Teilanzahl</b>	<b>: 43</b>	7. <input type="checkbox"/> Übersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache:	:
Sequenzprotokoll	:	8. <input type="checkbox"/> Gesonderte Angaben zu hinterlegten Mikroorganismen oder anderem biologischen Material	:
diesbezügliche Tabellen	:	9. <input type="checkbox"/> Sequenzprotokoll in computerlesbarer Form (Art und Anzahl der Datenträger)	:
(für beide, Anzahl der Blätter, soweit auf Papier eingereicht wird, unabhängig davon, ob zusätzlich auch in computerlesbarer Form eingereicht wird; siehe unter (c))	:	(i) <input type="checkbox"/> Kopie ausschließlich für die Zwecke der internationalen Recherche nach Regel 13ter (und nicht als Teil der internationalen Anmeldung)	:
<b>Gesamtanzahl</b>	<b>: 43</b>	(ii) <input type="checkbox"/> (nur falls Felder (b)(i) oder (c)(i) in der linken Spalte angekreuzt wurden) zusätzliche Kopien einschließlich, soweit zutreffend, einer Kopie für die Zwecke der internationalen Recherche nach Regel 13ter	:
(b) <input type="checkbox"/> ausschließlich in computerlesbarer Form (Abschnitt 801(a)(i))	:	(iii) <input type="checkbox"/> zusammen mit entsprechender Erklärung, daß die Kopie(n) mit dem in der linken Spalte aufgeführten Sequenzprotokoll identisch ist	:
(i) <input type="checkbox"/> Sequenzprotokoll	:	10. <input type="checkbox"/> Tabellen in computerlesbarer Form im Zusammenhang mit Sequenzprotokoll (Art und Anzahl der Datenträger)	:
(ii) <input type="checkbox"/> diesbezügliche Tabellen	:	(i) <input type="checkbox"/> Kopie ausschließlich für die Zwecke der internationalen Recherche nach Abschnitt 802(b-quater) (und nicht als Teil der internationalen Anmeldung)	:
(c) <input type="checkbox"/> auch in computerlesbarer Form (Abschnitt 801(a)(ii))	:	(ii) <input type="checkbox"/> (nur falls Felder (b)(ii) oder (c)(ii) in der linken Spalte angekreuzt wurden) zusätzliche Kopien einschließlich, soweit zutreffend, einer Kopie für die Zwecke der internationalen Recherche nach Abschnitt 802(b-quater)	:
(i) <input type="checkbox"/> Sequenzprotokoll	:	(iii) <input type="checkbox"/> zusammen mit entsprechender Erklärung, daß die Kopie(n) mit dem in der linken Spalte aufgeführten Tabellen identisch ist (sind)	:
(ii) <input type="checkbox"/> diesbezügliche Tabellen	:	11. <input type="checkbox"/> Sonstige (einzeln auflisten):	:
Art und Anzahl der Datenträger (Diskette, CD-ROM, CD-R oder sonstige) auf denen sich befinden	:		
(i) <input type="checkbox"/> Sequenzprotokoll:	:		
(ii) <input type="checkbox"/> diesbezügliche Tabellen:	:		
(zusätzliche eingereichte Kopien unter Punkt 9(ii) und/oder 10(ii) in der rechten Spalte angeben)	:		
Abbildung der Zeichnungen, die mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden soll (Nr.):	1	Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht wird:	Deutsch

**Feld Nr. X UNTERSCHRIFT DES ANMELDERS, DES ANWALTS ODER DES GEMEINSAMEN VERTRETERS**  
*Der Name jeder unterzeichnenden Person ist neben der Unterschrift zu wiederholen, und es ist anzugeben, sofern sich dies nicht eindeutig aus dem Antrag ergibt, in welcher Eigenschaft die Person unterzeichnet.*

Nürnberg. 13.07.2004

Norbert Zinsinger, Patentanwalt

Vom Anmeldeamt auszufüllen	
1. Datum des tatsächlichen Eingangs dieser internationalen Anmeldung:	2. Zeichnungen: <input type="checkbox"/> eingegangen:  <input type="checkbox"/> nicht eingegangen:
3. Geändertes Eingangsdatum aufgrund nachträglich, jedoch fristgerecht eingegangener Unterlagen oder Zeichnungen zur Vervollständigung dieser internationalen Anmeldung:	
4. Datum des fristgerechten Eingangs der angeforderten Richtigstellungen nach Artikel 11(2) PCT:	
5. Internationale Recherchenbehörde (falls zwei oder mehr zuständig sind): ISA /	6. <input type="checkbox"/> Übermittlung des Recherchenexemplars bis zur Zahlung der Recherchegebühr aufgeschoben

Vom Internationalen Büro auszufüllen
Datum des Eingangs des Aktenexemplars beim Internationalen Büro:

**Verfahren zur Erzeugung eines Flächenmusters hoher Auflösung**

5

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Erzeugen eines Flächenmusters hoher Auflösung auf einem Substrat, wobei bei dem Verfahren eine Drucksubstanz  
10 mittels eines Druckverfahrens musterförmig auf das Substrat aufgebracht wird.  
Die Erfindung betrifft weiter einen Mehrschichtkörper mit einer mittels eines Druckverfahrens musterförmig auf eine Substratschicht aufgetragenen Musterschicht und eine Vorrichtung zum Erzeugen eines Flächenmusters hoher Auflösung, das eine Druckstation zum musterförmigen Aufbringen einer viskosen  
15 Drucksubstanz auf einem Substrat aufweist.

Zum Aufbringen einer Drucksubstanz auf einem Substrat werden üblicherweise Tiefdruck-, Offset-, Hochdruck- und Siebdruckverfahren verwendet.

20 Der Tiefdruck bezeichnet ein Druckverfahren mit Druckelementen, die gegenüber der Formoberfläche tiefergelegt sind. Nach dem vollständigen Einfärben der Druckform wird die Oberfläche von der Druckfarbe befreit, so dass diese nur in den vertieften Stellen zurückbleibt. Die Art der Einfärbung und das Blankraken der Oberfläche gestatten keinen reinen Flächendruck, so dass ganze  
25 Zeichnungen in Linien, Punkte und Rasterelemente aufgelöst werden. Wegen der unterschiedlichen Tiefe und Größe der einzelnen Druckelemente fassen diese mehr oder weniger Druckfarbe, der Abdruck weist infolgedessen an den verschiedenen Bildstellen unterschiedliche Farbkraft auf.

30 Um die Auflösung dieser Druckverfahren zu verbessern, wird in DE 37 05 988 A1 vorgeschlagen, als Druckform eine homogene Folie zu verwenden, in die mittels

Feinstperforationsverfahren Druckinformationen in Form von Kapillaren als Druckgänge eingebracht werden. Eine niedrigviskose Drucksubstanz wird in die Kapillaren eingebracht und die Drucksubstanz aus den Kapillaren mit einer definierten Druckkraft als Feinstdruck auf den Bedruckstoff aufgebracht. Zur

Feinstperforation werden hierbei fokussierte Laserstrahlen mit einem Strahldurchmesser von 1 bis 10  $\mu\text{m}$  verwendet. Als Druckform dient eine 20 bis 50  $\mu\text{m}$  dicke, homogene Folie, beispielsweise eine Kunststoff- oder Metallfolie.

In DE 195 44 099 A1 wird vorgeschlagen, einen mit direkt aneinander liegenden Nöpfchen versehenen, transparenten Zylinder als Farb- oder Druckträger zu verwenden, wobei die Nöpfchen mit geschmolzener Farbe befüllt werden und anschließend die Farbe durch thermische Beeinflussung in einen festen Zustand gebracht wird.

In DE 197 46 174 C1 wird vorgeschlagen, in Nöpfchen kontinuierlich eine flüssige, meniskusbildende Drucksubstanz einzubringen und die Drucksubstanz in den Nöpfchen mittels eines von einer energiegebenden Einrichtung induzierten Vorgangs auf einem angenäherten Bedruckstoff zu übertragen.

Bei den oben beschriebenen bekannten Verfahren zur Verbesserung der mittels eines Druckverfahrens erzielbaren Auflösung wird demnach versucht, durch möglichst punktgenaues Aufbringen einer möglichst kleinen Menge an Drucksubstanz die erzielbare Auflösung zu verbessern.

Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, eine verbesserte Erzeugung eines Flächenmusters hoher Auflösung zu ermöglichen.

Diese Aufgabe wird von einem Verfahren zum Erzeugen eines Flächenmusters hoher Auflösung auf einem Substrat gelöst, bei dem eine Drucksubstanz mittels eines Druckverfahrens musterförmig auf das Substrat aufgebracht wird, bei dem zur Feinstrukturierung des Flächenmusters vor dem Aufbringen der

Drucksubstanz in die Oberfläche des Substrats eine mikroskopische Oberflächenstruktur mit einer Vielzahl von Rillen repliziert wird und bei dem die Feinstrukturierung des Flächenmusters durch die jeweils lokal aufgebrachte Auftragemenge an Drucksubstanz und die jeweiligen lokalen Reliefparameter der mikroskopischen Oberflächenstruktur, insbesondere Orientierungsrichtung und Profilform, bestimmt wird. Diese Aufgabe wird weiter von einer Vorrichtung zum Erzeugen eines Flächenmusters hoher Auflösung auf einem Substrat gelöst, die weiter eine Druckstation zum musterförmigen Aufbringen einer Drucksubstanz auf dem Substrat aufweist, die weiter eine vor der Druckstation angeordnete Replizierstation zur Feinstrukturierung des Flächenmusters aufweist, die in die Oberfläche des Substrats eine mikroskopische Oberflächenstruktur mit einer Vielzahl von Rillen repliziert, und bei der die Druckstation die Drucksubstanz derart auf die mikroskopische Oberflächenstruktur des Substrates aufbringt, dass sich eine vorbestimmte Feinstrukturierung des Flächenmusters durch die jeweils lokal aufgebrachte Auftragemenge an Drucksubstanz und die jeweiligen lokalen Reliefparameter der mikroskopischen Oberflächenstruktur, insbesondere Orientierungsrichtung und Profilform, ergibt. Diese Aufgabe wird weiter von einem Mehrschichtkörper gelöst, der eine Substratschicht und eine auf der Substratschicht in Form eines Flächenmusters hoher Auflösung angeordnete Musterschicht aus einer Drucksubstanz aufweist, wobei in die Oberfläche des Substrates zur Feinstrukturierung des Flächenmusters vor dem Aufbringen der Drucksubstanz eine mikroskopische Oberflächenstruktur mit einer Vielzahl von Rillen repliziert ist und die Feinstrukturierung des Flächenmusters durch die jeweils lokal aufgebrachte Auftragemenge an Drucksubstanz und die jeweiligen lokalen Reliefparameter der mikroskopischen Oberflächenstruktur, insbesondere Orientierungsrichtung, Profiltiefe und Profilform, bestimmt ist.

Bei der Erfindung wird demnach eine Verbesserung der Auflösung des entstehenden Druckbildes durch eine gezielte Beeinflussung der Oberflächenstruktur des Substrates bewirkt. Die genaue Form des Flächenmusters ergibt sich durch die Überlagerung dreier Effekte, zum einen der jeweils lokal aufgebrachten Auftragemenge einer Drucksubstanz, den rheologischen Eigenschaften der Drucksubstanz und zum andern der jeweiligen lokalen Relief-Parameter der mikroskopischen Oberflächenstruktur.

Durch die Erfindung lassen sich Auflösungen erzielen, die mit herkömmlichen Drucktechniken nicht erzeugbar sind. So lassen sich beispielsweise durch herkömmliche Tiefdruckverfahren Auflösungen im Bereich von circa 80 µm erzielen. Unter der Verwendung der Erfindung ist es hier möglich, die mittels eines Tiefdruckverfahrens erzielbare Auflösung auf circa 30 µm und weniger zu verbessern. Weitere Vorteile ergeben sich dadurch, dass verbreitete und ausgereifte Druck-Technologien für die Umsetzung der Erfindung verwendbar bleiben. Hierdurch ergeben sich erhebliche Kostenvorteile.

10

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind den Unteransprüchen zu entnehmen.

Besonders vorteilhaft ist es hierbei, eine Drucksubstanz mit einer vordefinierten Viskosität und Affinität zu verwenden. Die Viskosität der Drucksubstanz und die Affinität zwischen Drucksubstanz und Substrat beeinflussen das Fließverhalten der Drucksubstanz. Damit wird das sich ergebende Druckbild auch durch diese Größen beeinflusst. Besonders vorteilhaft ist es hierbei, eine Drucksubstanz mit einer Viskosität von 50 - 150 mPas zu wählen. Weiter ist es möglich, durch gezielte Wahl der Oberflächenspannung von Drucksubstanz und Drucksubstrat (Affinität) die Druckauflösung weiter zu beeinflussen. Bei der Auswahl einer Drucksubstanz, deren Viskosität vorzugsweise in diesem Größenbereich liegt, kommen die oben beschriebenen Effekte besonders zum Tragen, so daß sich ein Druckbild besonders hoher Auflösung erzeugen läßt.

25

Die Erfindung eignet sich besonders gut zum Aufbringen von Flächenmustern hoher Auflösung auf einen mehrschichtigen Folienkörper. So kann die Erfindung insbesondere bei der Herstellung von Heißpräge-, Laminier- oder Transferfolien verwendet werden. Diese Folien oder auch aus diesen Folien hergestellte Folienelemente können im Sicherheitsbereich, beispielsweise als optische Sicherheitselemente zur Sicherung von Banknoten, Kreditkarten,

30



Ausweispapieren und dergleichen, verwendet werden. Weiter können derartige Folien oder Folienelemente auch im dekorativen Bereich verwendet werden.

Als besonders vorteilhaft hat sich die Anwendung der Erfindung im Bereich der Demetallisierung/partiellen Abtragung von Substrat-Schichten erwiesen. Die durch die Erfindung erreichbare hohe Auflösung sowie der erzielbare hohe Qualitätsstandard sind hier von großem Vorteil. Mittels der Erfindung kann beispielsweise ein Ätzresist, ein Ätzmittel oder eine Waschmaske gemäß eines Flächenmusters hoher Auflösung auf eine partiell zu entfernende Substratschicht aufgebracht werden. Eine weitere vorteilhafte Anwendung besteht darin, mittels der Erfindung organisches Halbleitermaterial als Drucksubstanz in Form eines Flächenmusters hoher Auflösung auf eine Substratschicht aufzubringen, um beispielsweise organische Feldeffekttransistoren (OFETs) zu erzeugen.

Gemäß eines bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung wird die Feinstrukturierung des Flächenmusters durch Variation der Orientierungsrichtung der Rillen der mikroskopische Oberflächenstruktur bewirkt. Die Breite eines Flächenbereiches eines Flächenmusters wird hier durch Wahl des Winkels zwischen der Längsachse des Flächenbereiches und der Orientierungsrichtung des zugeordneten Teils der mikroskopischen Oberflächenstruktur bestimmt. So kann die Breite des Flächenbereiches variiert werden, indem in den Flächenbereich Bereiche mit unterschiedlicher Orientierung der Oberflächenstruktur vorgesehen werden. Diese Methode ist hierbei besonders einfach technisch implementierbar und besonders effektiv. Ein lokal auf die mikroskopische Oberflächenstruktur aufgebrachter mikrofeine Drucksubstanz, beispielsweise in Form eines Tropfens, wird in seinem Verlauf durch die mikroskopische Oberflächenstruktur beeinflusst. Auch die rheologische Eigenschaften der Drucksubstanz üben Einfluß auf die Feinstrukturierung aus. Der durch die mikroskopische Oberflächenstruktur bewirkte asymmetrische Verlauf der Drucksubstanz wird gezielt zur Erhöhung der Auflösung des Flächenmusters ausgenutzt.

Eine besonders große Variationen der Breite des Flächenbereiches des Flächenmusters ist hierbei dadurch erzielbar, indem in dem Flächenbereich mindestens zwei Bereiche mit um 90 Grad gegeneinander verdrehten Orientierungsrichtungen der Oberflächenstruktur vorgesehen werden.

5

Weiter ist es möglich, die Feinstrukturierung des Musters durch Variation der Profiltiefe der Rillen der mikroskopischen Oberflächenstruktur zu bewirken. Ebenso ist eine Feinstrukturierung des Flächenmusters durch Variation der Profiform der Rillen der mikroskopischen Oberflächenstruktur möglich. Durch

10 Variation der Profiltiefe und der Profiform lässt sich die von einem lokal aufgetragenen mikrofeinen Drucksubstanz-Tropfen eingenommene Benetzungsfläche variieren. Hierdurch lässt sich indirekt die Breite eines Flächenbereiches des Flächenmusters variieren, indem in dem Flächenbereich Bereiche mit unterschiedlichen Profiformen oder unterschiedlichen Profiltiefen der

15 Oberflächenstruktur vorgesehen werden. Weiter lässt sich durch asymmetrische Profiformen im zugeordneten Teil der mikroskopischen Oberflächenstruktur die Zentrierung eines Flächenbereiches des Flächenmusters verändern. Durch derartige asymmetrische Profiformen wird ein asymmetrischer Verlauf des auf die mikroskopische Oberflächenstruktur aufgetragenen mikrofeinen Drucksubstrat-

20 Tropfens bewirkt. Dieser Effekt wird gezielt zu einer weiteren Erhöhung der Auflösung des Flächenmusters eingesetzt.

Es ist möglich, die Feinstrukturierung des Flächenmusters sowohl durch Variation der Orientierungsrichtung der Rillen der mikroskopischen Oberflächenstruktur,

25 durch Variation der Profiltiefe der mikroskopischen Oberflächenstruktur und durch Variation der Profiformen der Rillen der mikroskopischen Oberflächenstruktur zu bewirken. Auch die rheologischen Eigenschaften der Drucksubstanz üben Einfluß auf die Feinstrukturierung aus. Durch eine Kombination der oben beschriebenen Effekte lässt sich so das gewünschte, hochauflösende Muster erzeugen.

30

Die oben beschriebenen Effekte kommen hierbei insbesondere dann zum Tragen, wenn die Breite der Flächenbereiche kleiner als 50 µm ist.

Besonders vorteilhaft ist es, mittels der Feinstrukturierung benachbarter Flächen durch Variation lokaler Reliefparameter der mikroskopischen Oberflächenstruktur Moiré-Muster zu erzeugen. Derartig hergestellte Moiré-Muster können mittels  
5 üblicher Druckverfahren nicht repliziert werden und sind daher als hochwertiges optisches Sicherheitsmerkmal verwendbar. Diese Vorteile ergeben sich ebenfalls bei der Erzeugung eines Mikroschrift-Musters mittels der Feinstrukturierung durch Variation lokaler Reliefparameter der mikroskopischen Oberflächenstruktur. Auch hier ergibt sich ein optisches Sicherheitsmerkmal, das nur schwer nachahmbar ist.

10

Weiter ist es möglich, durch Variation der Profiltiefe der Rillen der mikroskopischen Oberflächenstruktur einen Bereich mit vordefiniert variierender Dicke der Drucksubstanzschicht zu erzeugen. Dies kann zur Erzeugung von Linsenkörpern ausgenutzt werden: Als Drucksubstanz wird ein hochbrechender  
15 Lack verwendet. Durch die Variation der Profiltiefe der Rillen der mikroskopischen Oberflächenstruktur wird beim Aufbringen des hochbrechenden Lacks in diesem Bereich ein Linsenkörper erzeugt.

20

Das hochauflösende flächendeckende Muster lässt sich besonders einfach erzeugen, wenn die Feinstrukturierung des Flächenmusters durch Variation der Relief-Parameter der mikroskopischen Oberflächenstruktur bei in etwa konstanter Auftragemenge an Drucksubstanz pro Flächeneinheit bewirkt wird. Hierdurch wird der Rechenaufwand verringert, der zur Bestimmung der notwendigen mikroskopischen Oberflächenstruktur und des notwendigen Musters erforderlich  
25 ist, gemäß dem die Drucksubstanz auf das Substrat aufzubringen ist, um das vorgegebene hochauflösende Flächenmuster zu erzielen.

30

Besonders gute Ergebnisse werden dadurch erzielt, dass die mikroskopische Oberflächenstruktur eine Spatialfrequenz von mehr als 50 Rillen/mm, vorzugsweise von 100 bis 1200 Rillen/mm, und eine Profiltiefe von weniger als 2  $\mu\text{m}$ , vorzugsweise von 0,2 bis 1,2  $\mu\text{m}$  hat.

Eine Vorrichtung zum Erzeugen eines Flächenmusters gemäß der Erfindung weist vorzugsweise eine Druckstation mit einer Insetting-Einrichtung auf, um das passergenaue Aufbringen des Drucksubstrats auf die mikroskopische Oberflächenstruktur sicherzustellen. Besonders gute Ergebnisse lassen sich dadurch erzielen, dass die Vorrichtung einen Zentralzylinder aufweist, an dem die Replizierstation und die Druckstation angeordnet sind. Hierdurch wird ein passergenauer Aufdruck erreicht, so dass sich die Auflösung des Flächenmusters weiter verbessert.

Im folgenden wird die Erfindung anhand von mehreren Ausführungsbeispielen unter Zuhilfenahme der beiliegenden Zeichnungen beispielhaft verdeutlicht.

Fig. 1 zeigt ein Ablaufdiagramm, anhand dessen der Ablauf des erfindungsgemäßen Verfahrens verdeutlicht ist.

Fig. 2a bis

Fig. 2e zeigen schematische Darstellungen eines Mehrschichtkörpers, der gemäß des erfindungsgemäßen Verfahrens bearbeitet wird.

Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung einer Vorrichtung zum Erzeugen eines Flächenmusters gemäß der Erfindung.

Fig. 4a bis

Fig. 4c zeigen verschiedene Darstellungen eines erfindungsgemäßen Mehrschichtkörpers.

Fig. 5 zeigt eine Darstellung eines erfindungsgemäßen Mehrschichtkörpers für ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung.

Fig. 6 zeigt eine Schnittdarstellung eines Mehrschichtkörpers.

Fig. 7 zeigt eine weitere Schnittdarstellung eines Mehrschichtkörpers.

5 Fig. 8 zeigt eine weitere Schnittdarstellung eines Mehrschichtkörpers.

Fig. 9a bis

Fig. 9c zeigen Darstellungen erfindungsgemäßer Mehrschichtkörper für weitere Ausführungsbeispiele der Erfindung.

10

Fig. 10 zeigt einen erfindungsgemäßen Mehrschichtkörper mit einem Moiré-Muster für ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung.

Fig. 11 zeigt einen Schnitt durch einen erfindungsgemäßen Mehrschichtkörper für ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung.

15

Der Ablauf des erfindungsgemäßen Verfahrens wird im folgenden anhand der Figuren Fig. 1 und Fig. 2a bis Fig. 2e erläutert.

20 Fig. 1 zeigt mehrere Bearbeitungsstationen 14, 15, 16, 17 und 18 sowie eine Berechnungseinrichtung 11.

Die Bearbeitungsstationen 14, 15, 16, 17 und 18 führen Prozessschritte durch, mittels denen eine gemäß eines Flächenmusters 10 ausgeformte musterförmige Schicht aus einem reflektierenden Material auf einer Basisfolie erzeugt wird. Die Berechnungseinheit 11 generiert aus dem vorliegenden Flächenmuster 10 eine Spezifikation eines mikroskopischen Oberflächenmusters 12 und ein zugeordnetes Flächenmuster 13. Das Flächenmuster 13 beschreibt, in welcher Form eine Drucksubstanz musterförmig auf ein Substrat, in dessen Oberfläche die

25

mikroskopische Oberflächenstruktur 12 repliziert ist, aufgebracht werden muss, um letztendlich einen Drucksubstanz-Auftrag gemäß des Flächenmusters 10 zu erzielen. Wie im späteren noch detailliert beschrieben, ergibt sich hierbei die Feinstrukturierung des Flächenmusters 10 durch die jeweils lokal gemäß des Flächenmusters 13 aufgebrachte Auftragsmenge an Drucksubstanz und die jeweiligen lokalen Reliefparameter der mikroskopischen Oberflächenstruktur 12.

Der Bearbeitungsstation 14 wird der in Fig. 2a gezeigte Folienkörper zugeführt. Dieser Folienkörper besteht aus einer Trägerschicht 21 und einer Ablöse- und/oder Schutzlackschicht 22, die in einem hier nicht gezeigten Verfahrensschritt auf die Trägerfolie 21 aufgebracht ist. Bei der Trägerfolie 21 handelt es sich beispielsweise um eine Polyesterfolie einer Dicke von etwa 12 µm bis 50 µm. Die Ablöse- und/oder Schutzlackschicht 22 hat in etwa eine Dicke von 0,3 bis 1,2 µm. Auf diese Schicht könnte auch verzichtet werden.

Die Bearbeitungsstation 14 trägt auf den zugeführten Folienkörper nun eine Replizierschicht 23 auf. Die Replikationsschicht 23 besteht hierbei vorzugsweise aus einem transparenten, thermoplastischen Kunststoffmaterial, das beispielsweise mittels eines Druckverfahrens vollflächig auf den zugeführten Folienkörper aufgebracht wird.

Der Replizierlack hat hierbei beispielsweise folgende Zusammensetzung:

#### Komponentengewichtsteile

hochmolekulares PMMA-Harz	2000
Silikonalkyd ölfrei	300
nichtionisches Netzmittel	50
Niedrigviskose Nitrocellulose	750
Methylethylketon	1200
Toluol	2000
Diacetonalkohol	2500

Der Auftrag der Replizierschicht erfolgt beispielsweise mit einer Linienraster-Tiefdruckwalze mit einem Auftragegewicht von 2,2 g/m<sup>2</sup> nach Trocknung. Die  
5 Trocknung erfolgt im Trockenkanal bei einer Temperatur von 100 bis 120 Grad Celsius.

Der so gebildete Folienkörper 27 (Fig. 2b) wird nun der Bearbeitungsstation 15  
zugeführt.

10

Bei der Bearbeitungsstation 15 handelt es sich um eine Replizierstation, die die mikroskopische Oberflächenstruktur 12 in die Replizierschicht 23 repliziert.

15

Die Replikation kann hierbei mittels eines Prägewerkzeugs erfolgen. Es ist jedoch auch möglich, dass die Replikation mittels eines UV-Replikationsverfahrens durchgeführt werden kann, wie dies später beispielhaft anhand von Fig. 3 erläutert ist.

20

In die Replizierschicht 23 wird so beispielsweise bei etwa 160 Grad Celsius mittels einer aus Nickel bestehenden Matrize die mikroskopische Oberflächenstruktur 12 eingeprägt. Zum Prägen der mikroskopischen Oberflächenstruktur 12 wird die Matrize vorzugsweise elektrisch aufgeheizt. Vor dem Abheben der Matrize von der Replizierschicht 23 nach der Prägung kann die Matrize wieder abgekühlt werden. Nach Einprägung der mikroskopischen  
25 Oberflächenstruktur 12 erhärtet der Replizierlack durch Vernetzen oder in sonstiger Weise.

30

Fig. 2c zeigt nun den Mehrschichtkörper 27 nach Bearbeitung durch die Bearbeitungsstation 15. Wie in Fig. 2c gezeigt, ist nun in der Oberfläche der Replizierschicht 23 die mikroskopische Oberflächenstruktur 12 abgeformt. Der

derart bearbeitete Folienkörper kann nun der Bearbeitungsstation 16 zugeführt werden.

Die Bearbeitungsstation 16 beschichtet den ihr zugeführten Folienkörper mit einer dünnen Reflexionsschicht 25. Bei der Reflexionsschicht 25 handelt es sich vorzugsweise um eine dünne, aufgedampfte Metallschicht oder um eine HRI-Schicht (HRI = High Refraction Index). Als Materialien für die Metallschicht kommen im wesentlichen Chrom, Aluminium, Kupfer, Eisen, Nickel, Silber, Gold oder eine Legierung mit diesen Materialien in Frage.

Auf die Reflexionsschicht 25 kann auch verzichtet werden. Das Aufbringen der Reflexionsschicht 25 erfolgt vorzugsweise dann, wenn die folgenden Schritte z. B. eine Teilmetallisierung, beispielsweise durch Aufbringen eines Resistlacks und einen Ätzschritt, umfassen. Das Aufbringen der Reflexionsschicht 25 kann insbesondere dann entfallen, wenn leitfähige Polymere verdruckt werden. In diesem Fall besteht die Replikationsschicht aus einem ausgehärtetem Harz (z. B. UV-vernetzbares Harz, 2K-Lack), der durch das Aufbringen des leitfähigen Polymers nicht mehr angelöst wird, so dass es zu keiner Wechselwirkung zwischen dem repliziertem Lacksystem und dem verdruckten System kommt.

Fig. 2d zeigt nun einen Folienkörper 29 nach Bearbeitung durch die Bearbeitungsstation 16. Der Folienkörper 29 weist neben der Trägerschicht 21, der Ablöse- und/oder Schutzlackschicht 22 und der Replizierschicht 23 eine vollflächig aufgedampfte Reflexionsschicht 25 auf. Der Folienkörper 29 wird nun der Bearbeitungsstation 17 zugeführt. Die Bearbeitungsstation 17 trägt auf den Folienkörper 29 mittels eines Druckverfahrens eine Drucksubstanz mit geeigneter Viskosität und Affinität musterförmig gemäß des Flächenmusters 13 auf. Als Druckverfahren wird von der Bearbeitungsstation 17 vorzugsweise ein Tiefdruckverfahren verwendet. So erfolgt der Aufdruck der Drucksubstanz 26 beispielsweise mit einer Tiefdruckrasterwalze, die eine Vielzahl von Nöpfchen aufweist, die einen Farbauftrag gemäß des Flächenmusters 13 bewirken.



Es ist hier jedoch auch möglich, das Auftragen der viskosen Drucksubstanz 26 mittels eines anderen Druckverfahrens, beispielsweise mittels eines Offset-, Hochdruck-, Siebdruck- oder Flexodruckverfahrens durchzuführen.

- 5 Fig. 2e zeigt nun einen Folienkörper 28 nach der Bearbeitung durch die Bearbeitungsstation 17. Wie in Fig. 2e gezeigt, wird die Oberfläche des Folienkörpers 29 bereichsweise von der Drucksubstanz 26 bedeckt. Der Bedeckungsbereich, den die Drucksubstanz 26 einnimmt, entspricht hierbei nicht dem Auftragebereich, in dem die Drucksubstanz durch die Bearbeitungsstation 17  
10 auf die Oberfläche des Folienkörpers 29 aufgebracht ist. Der Bedeckungsbereich wird vielmehr durch die jeweils lokal aufgebrachte Auftragemenge an Drucksubstanz und die jeweiligen lokalen Reliefparameter der mikroskopischen Oberflächenstruktur 12 bestimmt, die, wie in den Figuren 2d oder 2e gezeigt, auch nach dem Aufbringen der Reflexionsschicht 25 noch in der Oberfläche der  
15 Reflexionsschicht 25 abgeformt ist.

Bei der Drucksubstanz 26 handelt es sich um einen Ätzresist, vorzugsweise auf Basis von Vinylchlorid/Vinylacetat-Copolymer.

- 20 Der Folienkörper 28 wird nun der Bearbeitungsstation 18 zugeführt. Bei der Bearbeitungsstation 18 handelt es sich um eine Demetallisierungsstation, die die nicht von Replizierlack bedeckten Bereiche der Reflexionsschicht 25 mittels Säure oder Lauge entfernt.
- 25 Nach dem Durchlaufen der Bearbeitungsstation 18 kann der Folienkörper 28 noch weitere Wasch-, Trocknungs- und Beschichtungsstationen durchlaufen. So ist es dann beispielsweise auch möglich, dass auf dem Folienkörper 28 im folgenden noch weitere Dekor- und/oder Klebeschichten aufgebracht werden. Weiter ist es natürlich auch möglich, vor dem Aufbringen der Replizierschicht 23 noch weitere  
30 Schichten auf dem von den Schichten 21 und 22 gebildeten Folienkörper aufzubringen, so dass der Folienkörper 28 beispielsweise als Teil einer Thermo-

Transferfolie, einer Prägefolie oder einer Laminierfolie mit rein optischen oder funktionellen Elementen Verwendung finden kann.

Es ist auch möglich, dass die Bearbeitungsstation 17 anstelle eines Ätzresists ein  
5 Ätzmittel auf die Reflexionsschicht 25 als Drucksubstanz aufträgt. Weiter ist es  
auch möglich, dass die Beschichtung mit der Reflexionsschicht 25 nicht vor dem  
Aufbringen der Drucksubstanz 26, sondern erst nach dem Aufbringen der  
Drucksubstanz 26 erfolgt. So kann die Drucksubstanz 26 beispielsweise eine  
Waschmaske bilden, die nach einer vollflächigen Beschichtung die partielle  
10 Entfernung der Reflexionsschicht 25 durch einen Waschvorgang ermöglicht.

Gemäß eines weiteren Ausführungsbeispiels der Erfindung wird auf die  
Bearbeitungsstationen 16 und 18 verzichtet, so dass durch die in Fig. 1 gezeigte  
Installation nunmehr eine hochauflösende, nach dem Flächenmuster 10  
15 ausgeführte Dekorlage auf einem Folienkörper erzeugt wird. Als Drucksubstanz  
kann hier eine übliche Druckfarbe verwendet werden, die beispielsweise aus  
einem Lösungsmittel mit 2 bis 25 % Festkörper besteht.

Weiter ist es möglich, als Drucksubstanz Polymere aufzubringen, mittels denen  
20 organische Halbleiterschaltungen realisiert werden. So können beispielsweise als  
Drucksubstanz organische Elektrodenmaterialien wie Polyanilin oder Polypyrrol,  
organische Halbleitermaterialien wie Polythiophen oder Isolatoren wie  
Polyphenylphenol verwendet werden. Mittels des Aufdrucks einer oder mehrerer  
derartiger Funktionspolymerschichten lassen sich beispielsweise organische  
25 Feldeffekttransistoren (OFETs) realisieren.

Hierbei ist es natürlich wesentlich, dass bei dem Ausdruck der  
Funktionspolymerschicht(en) auf etwaige Auswirkungen einer darunterliegenden  
metallischen und damit leitenden Reflexionsschicht geachtet wird. Eine derartige  
30 metallische Reflexionsschicht ist in ihrer Formgebung damit so zu gestalten, dass  
sie die elektrischen Wechselwirkungen der Funktionspolymerschichten nicht

beeinflusst (z. B. Kurzschluß) oder eine Funktion in der durch die Funktionspolymerschichten realisierten elektrischen Schaltung erbringt.

Fig. 3 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Vorrichtung zum Erzeugen des Flächenmusters 10.

Fig. 3 zeigt einen Zentralzylinder 34, zwei Rollen 31 und 32, eine Replizierstation 35, eine Druckstation 36 und zwei Führungsrollen 33.

Die Folienbahn wird von der Rolle 31 über den Zentralzylinder 34 zu der Rolle 32 geführt. Die Folienbahn besteht hierbei vorzugsweise aus einem Mehrschichtkörper, der mindestens eine Trägerschicht, beispielsweise bestehend aus einer 19 µm dicken PET-Folie und eine auf dieser aufgetragenen Replizierschicht aufweist. Natürlich ist es auch möglich, dass dieser Mehrschichtkörper noch eine Vielzahl weitere Schichten umfasst.

Die Replizierstation 35 repliziert, wie bereits anhand von Fig. 1 erläutert, mittels eines Prägewerkzeugs die mikroskopische Oberflächenstruktur 12 in die Replizierschicht der Folienbahn.

Weitere Vorteile sind hier erzielbar, wenn anstelle des in Fig. 1 beschriebenen Replizierverfahrens von der Replizierstation 35 ein UV-Replizierverfahren verwendet wird. Hierzu ist es vorteilhaft, an dem Zentralzylinder 34 vor der Replizierstation 35 eine Beschichtungsstation anzuordnen, die einen UV-Replizierlack auf die von der Rolle 31 zugeführte Folienbahn aufträgt. Die Replizierstation 35 enthält einen Maskenzylinder, der in den noch flüssigen UV-Replizierlack eintaucht und durch Bestrahlung des UV-Replizierlacks den UV-Replizierlack gemäß des Flächenmusters 12 aushärtet. Durch ein derartiges Replizierverfahren lassen sich sehr konturscharfe Oberflächenstrukturen mit einer großen Profiltiefe erzeugen. Weitere Vorteile bestehen darin, dass keine

thermische Verformung der Folienbahn auftritt. Insbesondere lassen sich so auch rechteckförmige Profilformen in hoher Qualität erzeugen.

Die Druckstation 36 weist eine Druckwalze auf, mittels der eine Drucksubstanz mit geeigneter Viskosität gemäß dem Flächenmuster 13 musterförmig und passergenau auf die mit der mikroskopischen Oberflächenstruktur 12 versehene Folienbahn aufgebracht wird.

Durch die Verwendung eines Zentralzylinders wird hier erreicht, dass die Passergenauigkeit des Auftrags der viskosen Drucksubstanz auf die mikroskopische Oberflächenstruktur 12 weiter verbessert wird. Um das hochauflösende Flächenmuster 10 zu erzeugen, ist es wesentlich, dass das musterförmige Aufbringen der Drucksubstanz gemäß des Flächenmusters 13 auf die mikroskopische Oberflächenstruktur 12 passergenau erfolgt, da ansonsten die Qualität des Ergebnisses absinkt und die gewünschte Auflösung nicht erzielt werden kann.

Anhand der Figuren Fig. 4a, Fig. 4b und Fig. 4c wird nun beispielhafte die Erzeugung eines Flächenbereiches 41 eines Flächenmusters hoher Auflösung erläutert.

Die Figuren Fig. 4a, Fig. 4b und Fig. 4c zeigen ein Substrat 40 mit zwei Oberflächenbereichen 43 und 42. In dem Oberflächenbereich 42 ist eine mikroskopische Oberflächenstruktur 45 mit einer Vielzahl von Rillen repliziert. In dem Oberflächenbereich 43 ist die Oberfläche des Substrates 40 glatt und weist keine mikroskopische Rillenstruktur auf.

Auf das Substrat 40 wird nun eine Drucksubstanz 44 musterförmig in Form eines rechteckförmigen Striches konstanter Dicke mittels eines Druckverfahrens aufgebracht. Im Flächenbereich 42 wird die Verlaufsform der aufgetragenen Drucksubstanz von den lokalen Reliefparametern der mikroskopischen

Oberflächenstruktur 45 beeinflusst. Wie in Fig. 4c dargestellt, ergibt sich durch die Orientierung der Rillen der mikroskopischen Oberflächenstruktur 42 ein asymmetrischer Verlauf der jeweils aufgetragenen mikrofeinen Druckschichtmenge, so dass trotz Auftrags in gleicher Dicke die Breite des Flächenbereiches 41 im Bereich 42 (Fig. 4c) geringer als im Bereich 41 (Fig. 4b) ist.

Fig. 5 verdeutlicht nun ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung, bei dem mittels Variation der Orientierungsrichtung der Rillen der mikroskopischen Oberflächenstruktur eine Feinstrukturierung des Flächenmusters bewirkt wird.

Fig. 5 zeigt ein Substrat 50, das mehrere Bereiche 52, 53 und 54 aufweist, in denen, wie in Fig. 5 schematisch dargestellt, die Rillen der mikroskopischen Oberflächenstruktur unterschiedliche Orientierung haben.

Auf dem Substrat 50 wird nun ein Druckschicht in Form eines rechteckförmigen Striches konstanter Breite aufgetragen. Wie in Fig. 5 gezeigt, ergibt sich durch den Einfluss der mikroskopischen Oberflächenstruktur hieraus ein Flächenmuster 51 in der in Fig. 5 gezeigten Form.

Die Breite eines Flächenbereiches des Flächenmusters 51 wird so wesentlich durch die Wahl des Winkels zwischen der Längsachse des Flächenbereichs und der Orientierungsrichtung des zugeordneten Teils der mikroskopischen Oberflächenstruktur bestimmt.

In dem Bereich 52 ist in die Oberfläche des Substrates 50 ein Sinusgitter mit einer Spatialfrequenz von 100L/mm und einer Profiltiefe von 400 nm abgeformt, wobei die Orientierungsrichtung der Rillen des Sinusgitters um 90 Grad gegenüber der Längsachse des strichförmigen Druckschicht-Auftrags gedreht ist. In dem Bereich 53 ist ein Sinusgitter mit einer Spatialfrequenz von 100L/mm und einer Profiltiefe von 400 nm in die Oberfläche des Substrates 50 abgeformt, wobei die

Orientierungsrichtung der Rillen des Sinusgitters der Längsachse des strichförmigen Drucksubstanz-Auftrags entspricht. Im Bereich 54 ist die Oberfläche unstrukturiert.

- 5 Wie in Fig. 5 gezeigt, wird die Breite der Flächenbereiche des Flächenmusters 51 wesentlich durch den Winkel zwischen der Längsachse des Flächenbereiches und der Orientierungsrichtung des zugeordneten Teils der mikroskopischen Oberflächenstruktur bestimmt. Sind, wie im Bereich 52, die Orientierungsrichtung des Gitters und die Längsachse des Flächenbereiches um 90 Grad
- 10 gegeneinander verdreht, wird die Breite des Flächenbereiches um ca. 15 Prozent gegenüber der unstrukturierten Fläche verbreitert. Stimmt die Orientierungsrichtung der Oberflächenstruktur und die Längsachse des Flächenbereiches überein, erfolgt eine Verjüngung des Flächenbereichs um ca. 15 Prozent gegenüber der unstrukturierten Fläche .

15

Besonders gute Ergebnisse bei der Umsetzung der oben beschriebenen Vorgehensweise lassen sich dann erzielen, wenn als Oberflächenstrukturen Sinusgitter mit einer Spatialfrequenz von 100 bis 600 L/mm und einer Profiltiefe von 400 nm bis 1200 nm. in Verbindung mit einer Drucksubstanz mit einer

20 Viskosität von 100 mPas eingesetzt werden.

Die Figuren Fig. 6 bis Fig. 9 zeigen nun mehrere Ausführungsbeispiele weiterer mikroskopischer Oberflächenstrukturen, mittels denen ein hochauflösendes Flächenmuster gemäß des erfindungsgemäßen Verfahrens herstellbar ist:

25

- Fig. 6 zeigt ein Substrat 60, in dessen Oberfläche eine mikroskopische Oberflächenstruktur 66 repliziert ist. Wie in Fig. 6 gezeigt, variiert die Profiltiefe der mikroskopischen Oberflächenstruktur 66 in den Bereichen 61, 62, 63, 64 und 65. Die Feinstrukturierung eines Flächenmusters wird so im Bereich der
- 30 Oberflächenstruktur 66 nicht nur, wie anhand von Fig. 5 beschrieben, durch die Variation der Orientierungsrichtung der Rillen der mikroskopischen Oberflächenstruktur 66 beeinflusst, sondern ebenfalls durch die Variation der

Profiltiefe der mikroskopischen Oberflächenstruktur. Durch eine Vergrößerung der Profiltiefe lässt sich so beispielsweise der Oberflächenanteil des Substrats, der von einem mikrofeinen Drucksubstanz-Tropfen benetzt wird, verringern. So ist es beispielsweise vorteilhaft, in dem Bereich 53 eine größere Profiltiefe als in dem Bereich 52 vorzusehen.

Fig. 7 zeigt ein Substrat 70, in dessen Oberfläche eine mikroskopische Oberflächenstruktur 73 repliziert ist. Wie in Fig. 7 gezeigt, ist in den Bereichen 71 und 72 das Tastverhältnis von Vertiefungen zu Erhöhungen der Reliefstruktur unterschiedlich. Hierdurch wird bewirkt, dass in dem Bereich 72 das Volumen der Vertiefungen höher als in dem Bereich 71 ist, wodurch ein dem Effekt der Vertiefung der Profiltiefe ähnlicher Effekt erzielt werden kann.

Fig. 8 zeigt ein Substrat 80, in dessen Oberfläche eine mikroskopische Oberflächenstruktur 83 repliziert ist. Bei dieser asymmetrischen Oberflächenstruktur handelt es sich um ein Sägezahngritter. Durch ein derartiges Sägezahngritter wird der Effekt erzielt, dass die Zentrierung des auf diese Oberflächenstruktur aufgetragenen Drucksubstrat-Auftrags verändert wird. So wird beispielsweise in dem Bereich 81 die Zentrierung des Drucksubstratauftrags etwas nach links verzogen und in dem Bereich 82 die Zentrierung des auf diesen Bereich aufgetragenen Farbauftrags etwas nach rechts verzogen. Damit wird letztendlich eine Vergrößerung der Distanz zwischen Flächenbereichen des Flächenmusters in den Bereichen 81 und 82 erzielt.

Im folgenden werden anhand der Figuren Fig. 9a bis Fig. 9c mehrere Ausführungsbeispiele der Erfindung beschrieben, bei denen die anhand der Figuren Fig. 5 bis Fig. 8 erläuterten Effekte zum Einsatz kommen.

Fig. 9a zeigt ein Substrat 90, und ein auf dem Substrat 90 erzeugtes hochauflösendes Flächenmuster 93. In den Bereichen 91 und 92 sind unterschiedliche mikroskopische Oberflächenstrukturen in der Oberfläche des Substrates 90 abgeformt. So ist in dem Bereich 92 eine mikroskopische

Oberflächenstruktur abgeformt, deren Rillen gemäß einer Richtung 99 orientiert sind, die eine Spatialfrequenz vorzugsweise im Bereich von 100L/mm aufweist und deren Profiltiefe im Bereich von 600 nm liegt. In dem Bereich 91 ist eine mikroskopische Oberflächenstruktur abgeformt, deren Rillen um 90 Grad gegenüber den Rillen der Oberflächenstruktur im Bereich 92 verdreht sind, deren Spatialfrequenz bevorzugt in dem Bereich von 100L/mm liegt und die bevorzugt eine Profiltiefe von 600 nm besitzt.

Auf das Substrat 90 wird nun eine Drucksubstanz in Form zweier paralleler, in Richtung 99 orientierter Linien aufgebracht. Durch die Reliefparameter der mikroskopischen Oberflächenstruktur in den Bereichen 91 und 92 wird erreicht, dass im Bereich 91 das Flächenmuster 99 einen vollflächigen Oberflächenbereich ausformt und in dem Bereich 92 das Flächenmuster 93 zwei dünne, in geringem Abstand beabstandete Schenkel ausformt (siehe Fig. 9a). Vorteilhaft ist hierbei, dass ein sehr geringer Abstand zwischen den Schenkeln des Flächenbereiches 92 erzielbar ist. So kann dieser Abstand beispielsweise 30 µm oder weniger betragen.

Fig. 9b zeigt das Substrat 90 und ein auf dem Substrat 90 erzeugtes Flächenmusters 95 hoher Auflösung. In Bereichen 93 und 94 sind in der Oberfläche des Substrats 90 mikroskopische Oberflächenstrukturen mit unterschiedlichen Reliefparametern abgeformt. In dem Bereich 93 ist eine mikroskopische Oberflächenstruktur abgeformt, deren Rillen gemäß der Richtung 99 orientiert sind und die ein symmetrisches Reliefprofil mit einer Spatialfrequenz im Bereich von 100 bis 600L/mm und einer Profiltiefe in dem Bereich von 400 bis 1100 nm aufweist. In dem Bereich 94 ist eine mikroskopische Oberflächenstruktur abgeformt, deren Orientierungsrichtung mit der der Oberflächenstruktur in dem Bereich 93 übereinstimmt, die im Gegensatz zu der Oberflächenstruktur im Bereich 93 jedoch eine asymmetrische Profilform, beispielsweise wie anhand von Fig. 8 erläutert, aufweist.

Wird nun auf die Flächenbereiche 93 und 94 Drucksubstanz in Form einer dünnen, in Längsrichtung des Substrates orientierten Linie aufgebracht, so ergibt



sich der in Fig. 9b gezeigte Effekt einer asymmetrischen Verjüngung des erzeugten Flächenmusters im Bereich 94.

Dieser Bereich kann, wie in Fig. 9c dargestellt, zur Erzeugung zweier sehr nahe  
5 beieinander liegenden Linien ausgenutzt werden.

Fig. 9c zeigt so das Substrat 90, auf dem ein Flächenmusters 98 hoher Auflösung erzeugt ist. In dem Bereich 96 ist die mikroskopische Oberflächenstruktur des Bereiches 93 nach Fig. 9b in dem Substrat 90 abgeformt. In dem Bereich 97 ist,  
10 wie in dem Bereich 94 nach Fig. 9b, eine Oberflächenstruktur mit einem asymmetrischen Reliefprofil abgeformt. Hierbei ist in dem rechten Teilbereich des Bereiches 97 das asymmetrische Profil wie in dem Bereich 82 nach Fig. 8 orientiert und in dem linken Teilbereich des Bereiches 97 wie in dem Bereich 81 nach Fig. 8 orientiert.

15 Wird nun ein Drucksubstrat in Form zweier dünner, parallel zueinander liegender Linien auf die Bereiche 96 und 97 aufgebracht, so wird das in Fig. 9c dargestellte Flächenmuster 98 generiert.

20 Durch eine derartige Vorgehensweise lassen sich Schenkel in dem Bereich 97 erzeugen, die nur 25µm voneinander beabstandet sind.

Durch eine Kombination der in den Figuren 5 bis 9c geschilderten Techniken lassen sich vielfältige hochauflösende Flächenmuster erzeugen. So werden die  
25 oben geschilderten Zusammenhänge beispielsweise in der Berechnungseinrichtung 11 codiert, so dass zu einem vorgegebenen, vordefinierten Flächenmuster hoher Auflösung die hierfür notwendige Gestaltung der mikroskopischen Oberflächenstruktur und des zugeordneten Flächenmusters, in dem der Drucksubstanz-Auftrag zu erfolgen hat, berechnet werden kann.

Fig. 10 zeigt nun eine bevorzugte Ausführungsform eines mit der Erfindung generierbaren Flächenmusters. Fig. 10 zeigt ein Substrat 100, auf dem ein Flächenmuster mit mehreren parallel zueinander liegenden Flächenbereichen 101 bis 105 erzeugt ist. Auf der Oberfläche des Substrates 100 ist eine

5 mikroskopische Oberflächenstruktur abgeformt, die sich aus einer Vielzahl von schachbrettartig angeordneten Teilstrukturen zusammensetzt. In jeder der Teilstrukturen unterscheiden sich die Reliefparameter von den Reliefparametern der umgebenen Teilstrukturen.

10 Fig. 10 zeigt so beispielhaft mehrere Teilstrukturen 106 bis 115. Die Teilstrukturen 106, 108, 110, 112 und 114 werden von einer mikroskopischen Struktur gebildet, wie sie in dem Bereich 52 nach Fig. 5 vorgesehen ist. Die Teilstrukturen 107, 109, 111, 113 und 115 werden jeweils von einer mikroskopischen Struktur gebildet, wie sie in dem Bereich 52 nach Fig. 5 vorgesehen ist. Hierdurch ergibt sich bei

15 Auftrag eines Drucksubstrats in Form einer dünnen Linie auf die Bereiche der Teil-Strukturen 106 bis 115 eine in ihrer Dicke variierenden Linie, wie sie in Fig. 10 in den Flächenbereichen 101, 102 und 105 des Flächenmusters gezeigt ist.

Durch eine Abänderung der Oberflächenstruktur von Teilstrukturen ist es nun

20 möglich, die Gleichmäßigkeit des Musters zu unterbrechen und hierbei jedoch den mittleren, für das menschliche Auge auflösbaren Eindruck (mittlere Bedeckungsfläche durch Drucksubstrat) konstant zu halten.

Dies ist in Fig. 10 beispielhaft anhand der Veränderung der Strukturen 117 und

25 120 aufgezeigt: Die Teilstrukturen 119, 116, 121 und 118 der mikroskopischen Oberflächenstruktur sind noch nach dem oben geschilderten Schema ausgeführt. Die Teilstrukturen 120 und 117 weisen jeweils zwei Teilbereiche auf, in denen die Orientierung der Rillen um 90 Grad gegenüber einander verschoben sind. Hierdurch wird erzielt, dass im linken Teilbereich der Teilstruktur 117 die

30 Liniendicke reduziert und im rechten Teil der Teilstruktur 120 die Liniendicke erhöht wird. Die Bedeckungsfläche bleibt damit im Mittel gleich, die Veränderung der Mikrostruktur kann jedoch als Moiré-Muster durch ein entsprechendes Auswertegerät erkannt und als Zusatzinformation ausgewertet werden.

Fig. 11 zeigt nun eine Möglichkeit, mittels der oben geschilderten Techniken die Dicke der Drucksubstanz-Schicht auf vordefinierte Art zu variieren.

- 5 Fig. 11 zeigt ein Substrat 130, in das eine mikroskopische Oberflächenstruktur repliziert ist. In den Bereichen 131 und 132 der mikroskopischen Oberflächenstruktur variiert nun die Profiltiefe der Oberflächenstruktur. Wie in Fig. 11 gezeigt, ist im Zentrum der Bereiche 131 und 132 die Profiltiefe am höchsten und nimmt zu den Begrenzungslinien der Bereich 131 und 132 hin ab.

10

- Wird nun ein hochbrechender Lack als Drucksubstanz auf die Bereiche 131 und 132 aufgebracht, so folgt die Schichtdicke des aufgetragenen Drucksubstrats der Profiltiefe der mikroskopischen Oberflächenstruktur. Durch den Auftrag des hochbrechenden Drucksubstrats auf die Flächenbereiche 131 und 132 werden  
 15 damit Linsenkörper 133 und 134 erzeugt, die gemäß des vorgegebenen Profiltiefen-Profils der mikroskopischen Oberflächenstruktur konvexe oder konkave Eigenschaften besitzen.

20

## **Ansprüche:**

5

1. Verfahren zum Erzeugen eines Flächenmusters (41, 51, 93, 95, 98) hoher Auflösung auf einem Substrat (40, 27, 50, 90, ), wobei bei dem Verfahren eine Druckschicht (44, 26, 2) mittels eines Druckverfahrens musterförmig auf das

10

dadurch gekennzeichnet ,

dass zur Feinstrukturierung des Flächenmusters (41, 51, 93, 95, 98) vor dem Aufbringen der Druckschicht in die Oberfläche des Substrats eine mikroskopische Oberflächenstruktur (24, 45, 52, 53, 54, 61 bis 65, 71, 72, 81, 82)

15

mit einer Vielzahl von Rillen repliziert wird, und dass die Feinstrukturierung des Flächenmusters (41, 51, 93, 95, 98) durch die jeweils lokal aufgetragene Auftragsmenge an Druckschicht (44, 26) und die jeweiligen lokalen Relief-Parameter der mikroskopischen Oberflächenstruktur (45, 24, 52 bis 54, 63 bis 64, 71, 72, 81, 82), insbesondere Orientierungsrichtung und Profilform, bestimmt wird.

20

2. Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet ,

dass die Feinstrukturierung des Flächenmusters (41, 51, 93, 95, 98) durch Variationen der Orientierungsrichtung der Rillen der mikroskopischen

25

Oberflächenstruktur (24, 45, 52, 53, 54) bewirkt wird.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet ,

dass die Feinstrukturierung des Flächenmusters (93, 95, 98) durch Variationen der Profiltiefe der Rillen der mikroskopischen Oberflächenstruktur (61 bis 65) bewirkt wird.

5 4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die Feinstrukturierung des Flächenmusters (93, 95, 98) durch Variationen der Profilform der Rillen der mikroskopische Oberflächenstruktur (71, 72, 81, 82) bewirkt wird.

10

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die Breite eines Flächenbereiches des Flächenmusters (41, 51) durch Wahl des Winkels zwischen der Längsachse des Flächenbereiches und der

15 Orientierungsrichtung des zugeordneten Teils der mikroskopischen Oberflächenstruktur (45) bestimmt wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

20 dass die Breite eines Flächenbereiches des Flächenmusters (51) variiert wird, indem in dem Flächenbereich Bereiche (52, 53) mit unterschiedlicher Orientierungsrichtung der Oberflächenstruktur vorgesehen werden.

7. Verfahren nach Anspruch 6,

25 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die Breite des Flächenbereiches des Flächenmusters (51) variiert wird, indem in dem Flächenbereich mindestens zwei Bereiche (52, 53) mit um 90 Grad gegeneinander verdrehten Orientierungsrichtungen der Oberflächenstruktur vorgesehen werden.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die Breite des Flächenbereiches des Flächenmusters (51) variiert wird,

5 indem in dem Flächenbereich Bereiche mit unterschiedlicher Profilform und/oder  
Profiltiefe der Oberflächenstruktur vorgesehen werden.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

10 dass die Zentrierung eines Flächenbereiches des Flächenmusters (95, 98,) durch  
eine asymmetrische Profilform im zugeordneten Teil der mikroskopischen  
Oberflächenstruktur verändert wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 9,

15 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die Breite des Flächenbereiches kleiner als 50 µm.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ;

20 dass mittels der Feinstrukturierung benachbarter Flächenbereiche durch Variation  
lokaler Relief-Parameter der mikroskopischen Oberflächenstruktur Moiré-Muster  
(101, 102, 103, 104, 105) erzeugt werden.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

25 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass mittels der Feinstrukturierung durch Variation lokaler Relief-Parameter der  
mikroskopischen Oberflächenstruktur ein Mikroschrift-Muster erzeugt wird.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass durch Variation der Profiltiefe der Rillen der mikroskopischen Oberflächenstruktur (131, 132) ein Bereich mit vordefiniert variierender Dicke der Druckschicht (133, 134) erzeugt wird.

14. Verfahren nach Anspruch 13,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass als Druckschicht ein hochbrechender Lack verwendet wird und dass durch die Variation der Profiltiefe der Rillen in dem Bereich ein Linsenkörper erzeugt wird.

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die Feinstrukturierung des Flächenmusters durch Variation der Reliefparameter der mikroskopischen Oberflächenstruktur bei in etwa konstanter Auftragsmenge an Druckschicht pro Flächeneinheit bewirkt wird.

16. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die mikroskopische Oberflächenstruktur eine Spatialfrequenz von mehr als 50 Rillen/mm, vorzugsweise von 100 bis 1200 mm Rillen/mm, und eine Profiltiefe von weniger als 2  $\mu\text{m}$ , vorzugsweise von 0,2 bis 1,2  $\mu\text{m}$ , aufweist.

17. Mehrschichtkörper (28), der eine Substratschicht (25) und eine auf der Substratschicht angeordnete Musterschicht (26) aufweist, die auf der

Substratschicht musterförmig in Form eines Flächenmusters hoher Auflösung ausgeformt ist, wobei die Musterschicht (26) aus einer Druckschicht besteht, die mittels eines Druckverfahrens musterförmig auf die Substratschicht aufgebracht

ist,

dadurch gekennzeichnet ,

dass in die Oberfläche der Substratschicht zur Feinstrukturierung des Flächenmusters vor dem Aufbringen der Drucksubstanz eine mikroskopische Oberflächenstruktur (24) mit einer Vielzahl von Rillen repliziert ist, wobei die Feinstrukturierung des Flächenmusters durch die jeweils lokal aufgebrachte Auftragemenge an Drucksubstanz und jeweilige lokale Relief-Parameter der mikroskopischen Oberflächenstruktur, insbesondere Orientierungsrichtung und Profilform, bestimmt ist.

10 18. Mehrschichtkörper nach Anspruch 17,

dadurch gekennzeichnet ,

dass der Mehrschichtkörper eine Folie, insbesondere eine Heißprägefolie oder Laminierfolie ist.

15 19. Mehrschichtkörper nach einem der Ansprüche 17 bis 18,

dadurch gekennzeichnet ,

dass die Drucksubstanz ein Ätzresist ist.

20. Mehrschichtkörper nach einem der Ansprüche 17 bis 18,

20 dadurch gekennzeichnet ,

dass die Drucksubstanz ein Ätzmittel ist.

21. Mehrschichtkörper nach einem der Ansprüche 17 bis 18

dadurch gekennzeichnet ,

25 dass die Drucksubstanz ein organisches Halbleitermaterial enthält.

22. Vorrichtung zum Erzeugen eines Flächenmusters hoher Auflösung auf einem Substrat, wobei die Vorrichtung eine Druckstation (36) zum musterförmigen Aufbringen einer Drucksubstanz auf dem Substrat aufweist,



dadurch gekennzeichnet ,

dass die Vorrichtung eine vor der Druckstation (36) angeordnete Replizierstation (35) zur Feinstrukturierung des Flächenmusters aufweist, die so ausgestaltet ist, dass sie in die Oberfläche des Substrats eine mikroskopische Oberflächenstruktur mit einer Vielzahl von Rillen repliziert, und dass die Druckstation (36) weiter so ausgestaltet ist, dass sie die Drucksubstanz derart auf die mikroskopische Oberflächenstruktur des Substrates aufbringt, dass sich eine vorbestimmte Feinstrukturierung des Flächenmusters durch die jeweils lokal aufgebrachte Auftragemenge an Drucksubstanz und die jeweiligen lokalen Relief-Parameter der mikroskopischen Oberflächenstruktur, insbesondere Orientierungsrichtung und Profilform, ergibt.

23. Vorrichtung nach Anspruch 22,

dadurch gekennzeichnet ,

dass die Druckstation (36) eine Einrichtung zum passergenauen Aufbringen der Drucksubstanz aufweist.

24. Vorrichtung nach Anspruch 22,

dadurch gekennzeichnet ,

dass die Vorrichtung einen Zentralzylinder (34) aufweist, an dem die Replizierstation (35) und die Druckstation (36) angeordnet ist.

5

### Zusammenfassung:

- 10 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Erzeugen eines Flächenmusters (10)  
hoher Auflösung auf einem Substrat sowie einen mittels dieses Verfahrens  
hergestellten Mehrschichtkörper und eine Vorrichtung zur Durchführung des  
Verfahrens. Eine Drucksubstanz wird mittels eines Druckverfahrens (17)  
musterförmig auf das Substrat aufgebracht. Zur Feinstrukturierung des  
15 Flächenmusters (10) wird vor dem Aufbringen der Drucksubstanz in die  
Oberfläche des Substrats eine mikroskopische Oberflächenstruktur (12) mit einer  
Vielzahl von Rillen repliziert. Die Feinstrukturierung des Flächenmusters wird  
durch die jeweils lokal aufgebrachte Auftragemenge an Drucksubstanz (13) und  
die jeweiligen lokalen Reliefparameter der mikroskopischen Oberflächenstruktur  
20 (12), insbesondere Orientierungsrichtung und Profilform, bestimmt.

(Fig. 1)

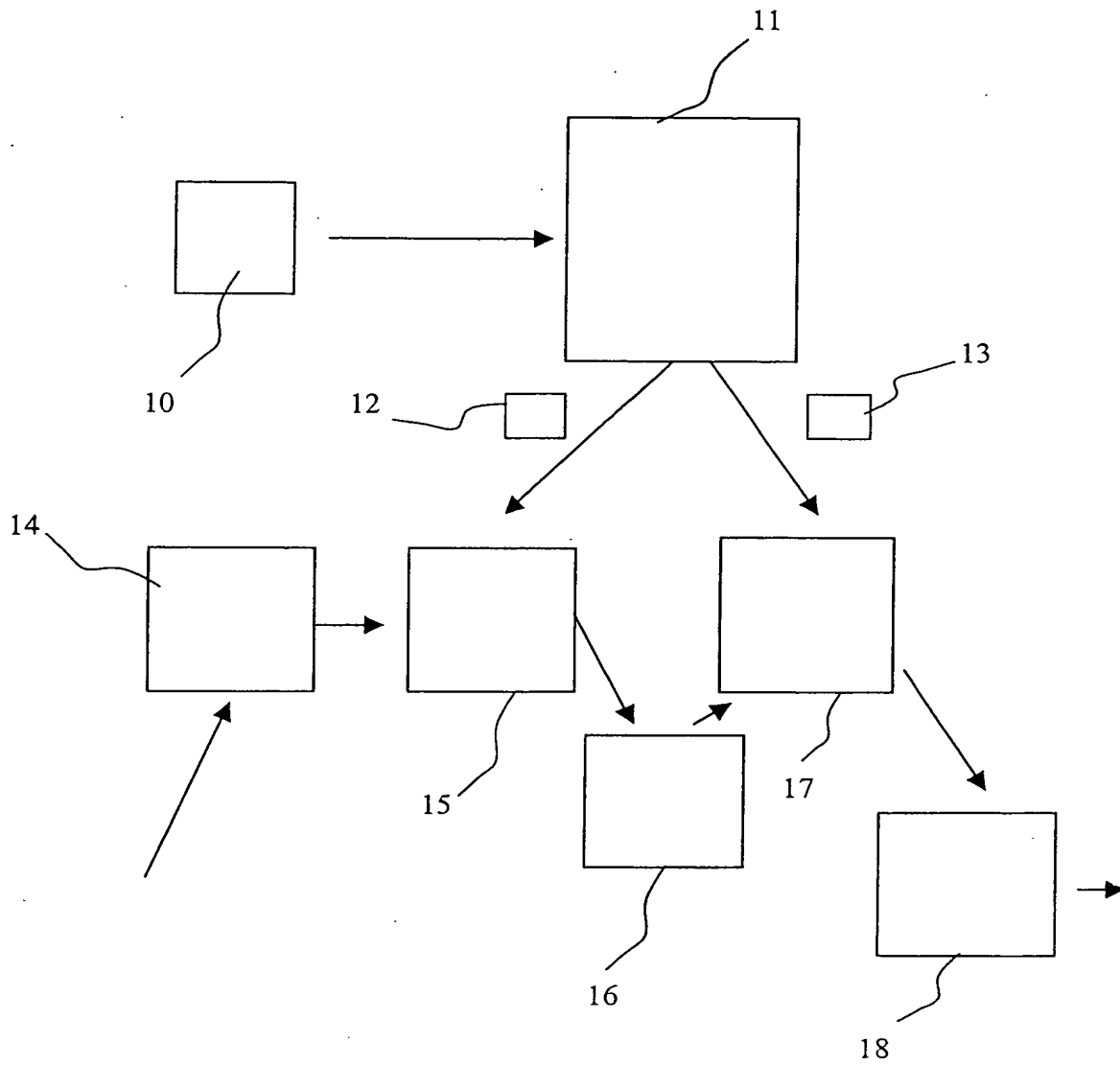


Fig. 1

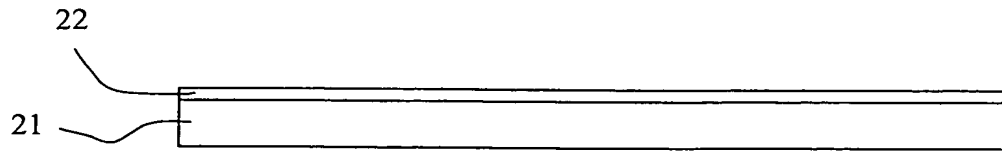


Fig. 2a

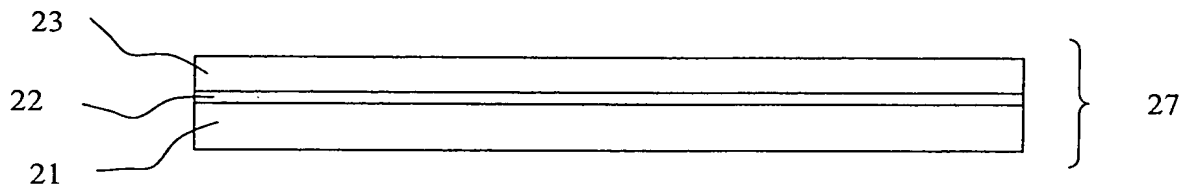


Fig 2 b

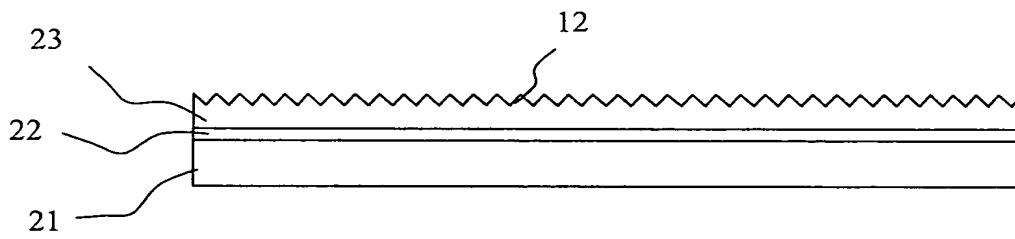


Fig 2 c

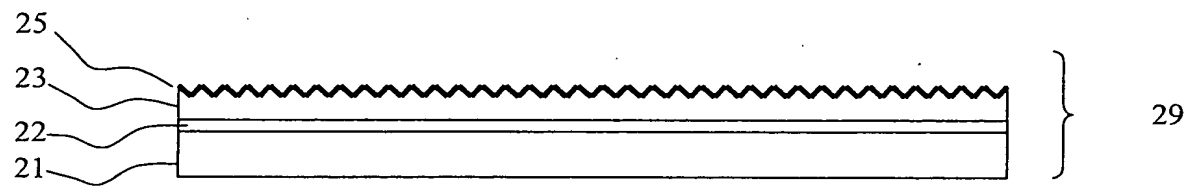


Fig. 2 d

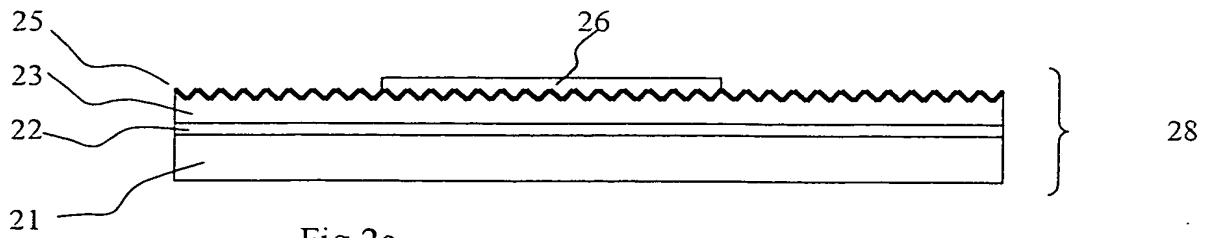


Fig 2e

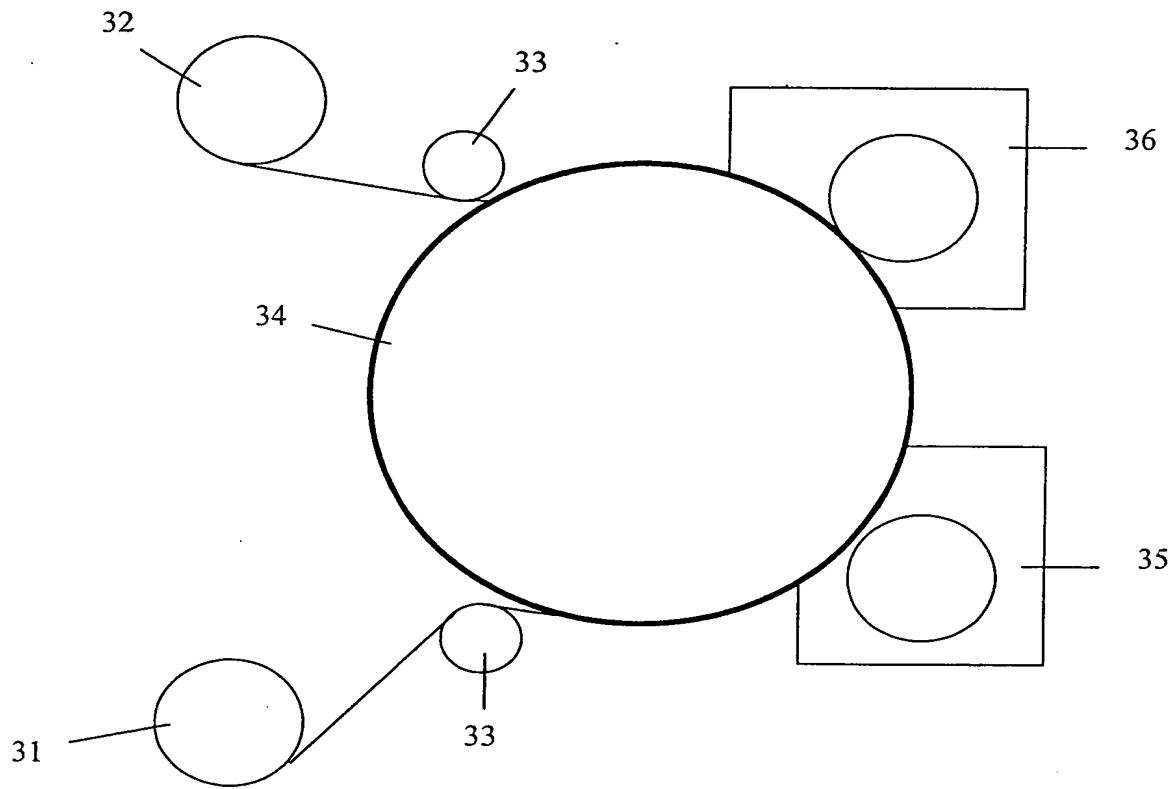


Fig. 3

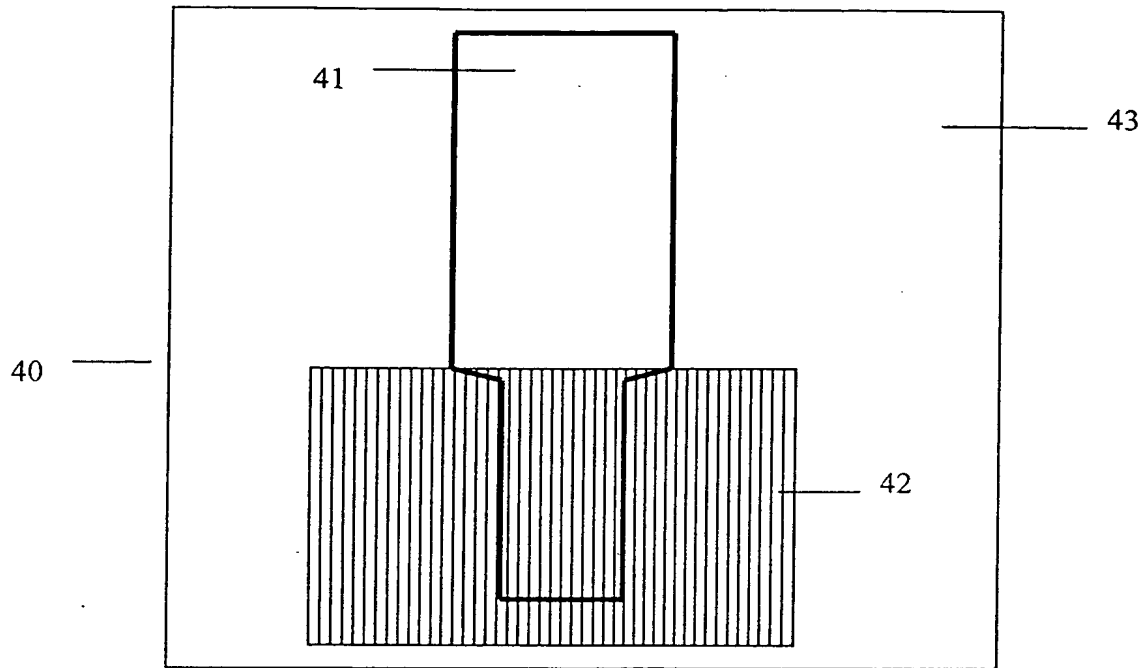


Fig. 4 a

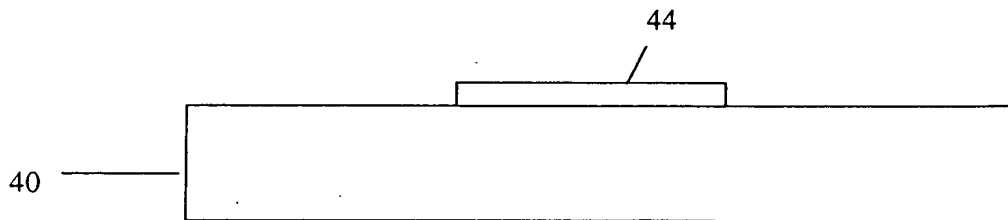


Fig. 4 b

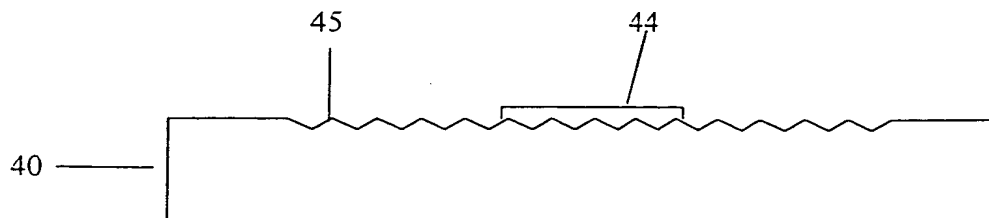


Fig. 4 c

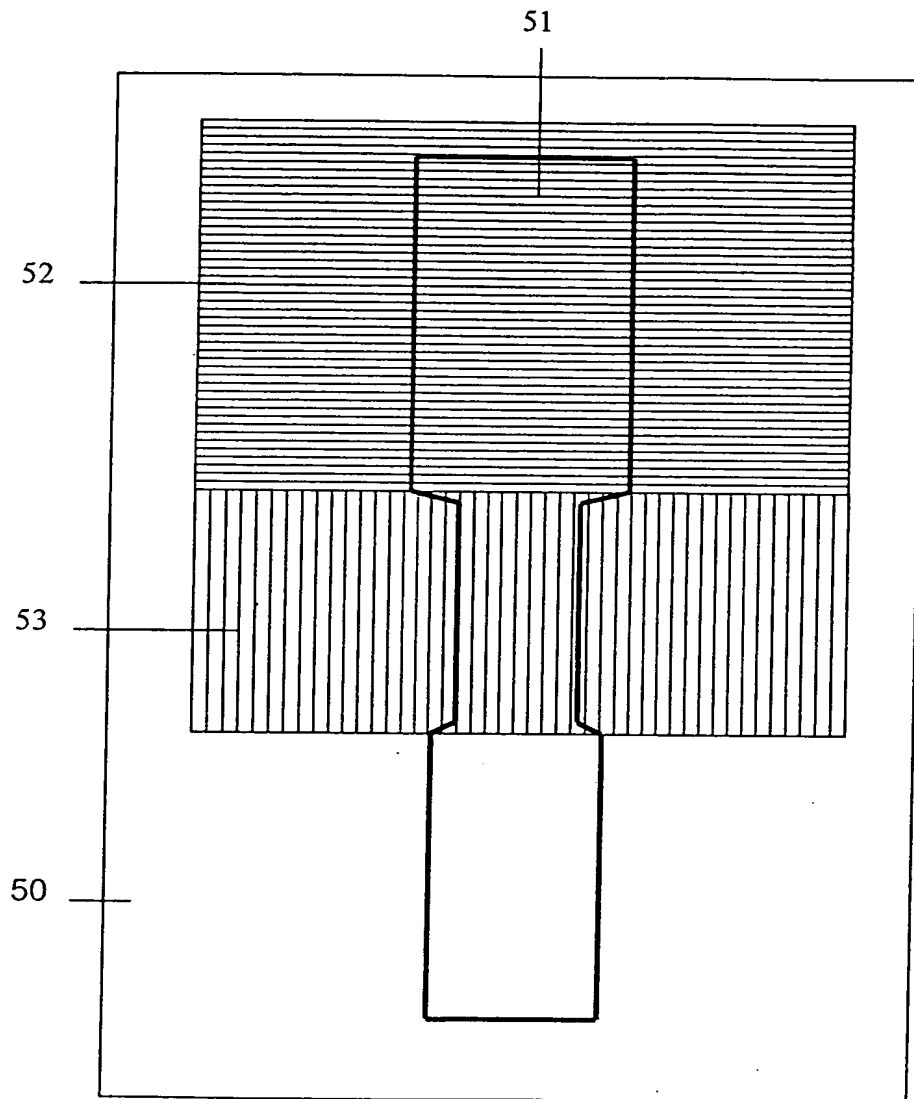


Fig. 5

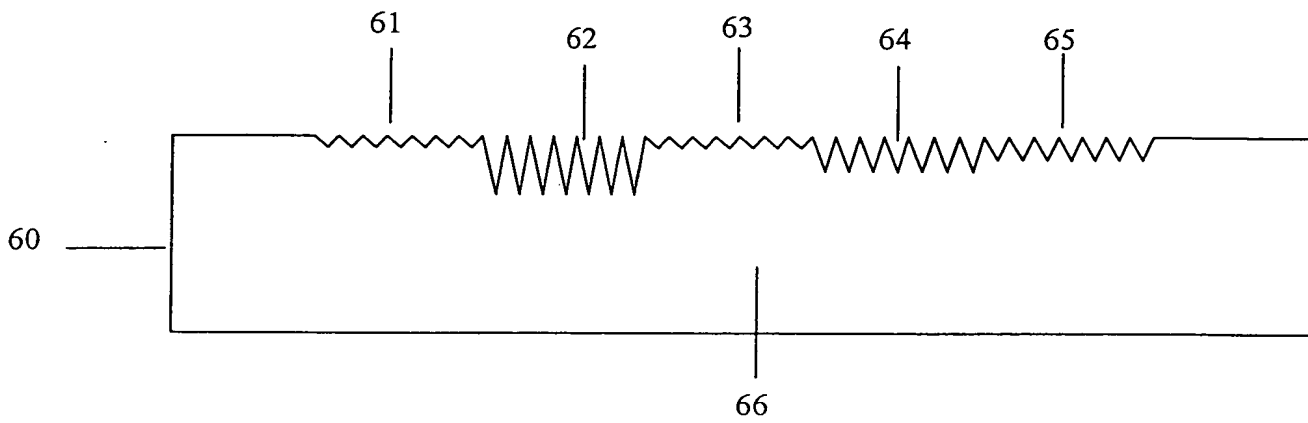


Fig. 6

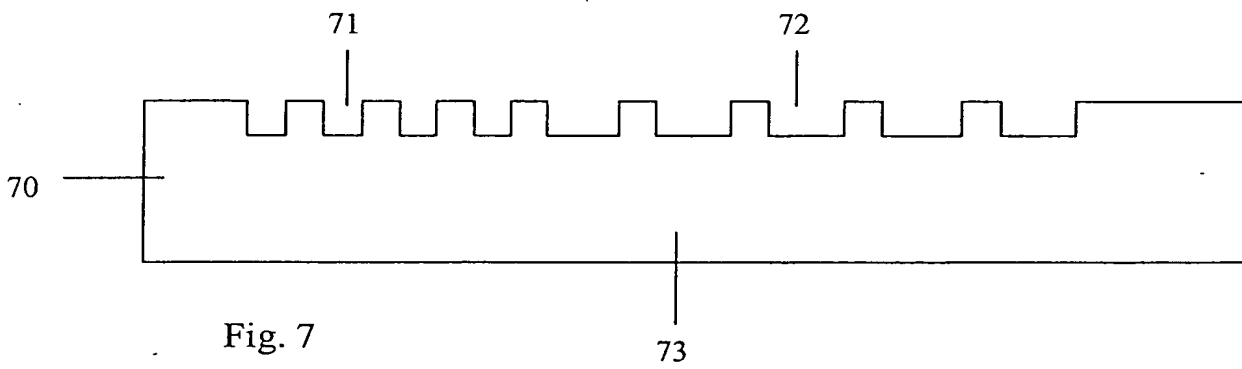


Fig. 7

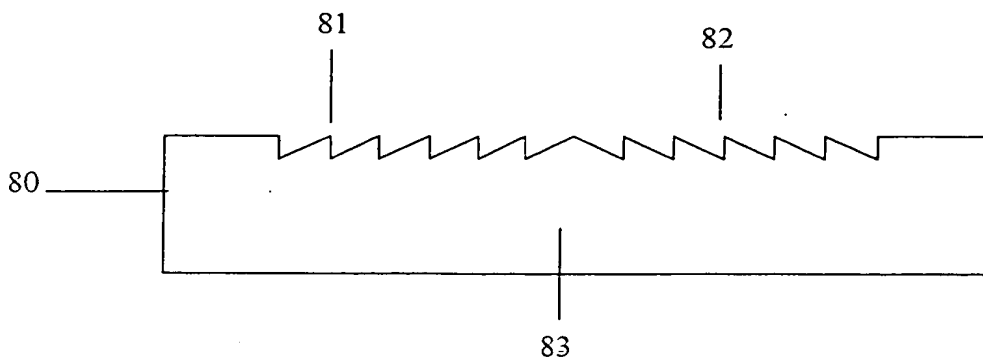


Fig. 8



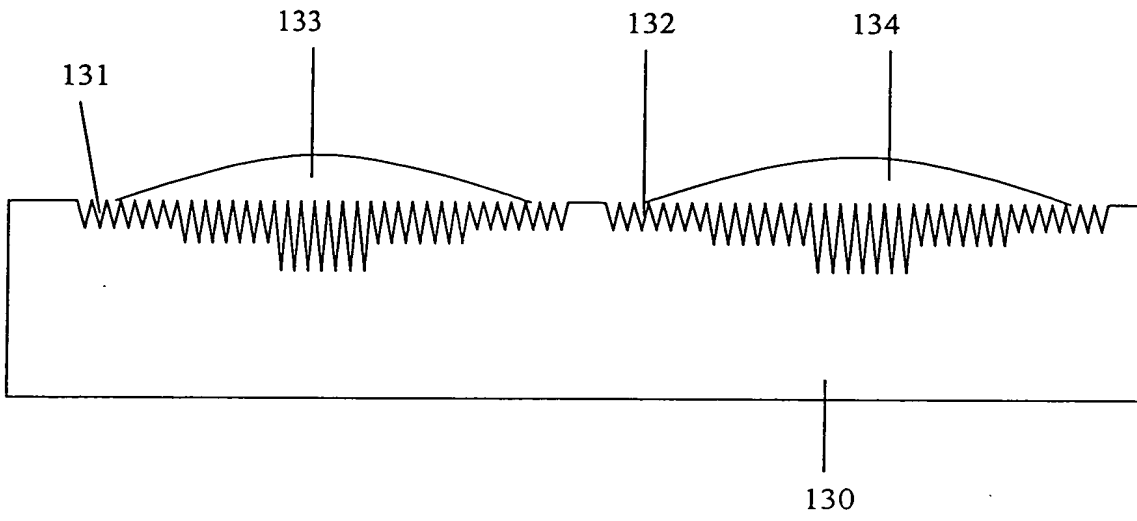


Fig. 11

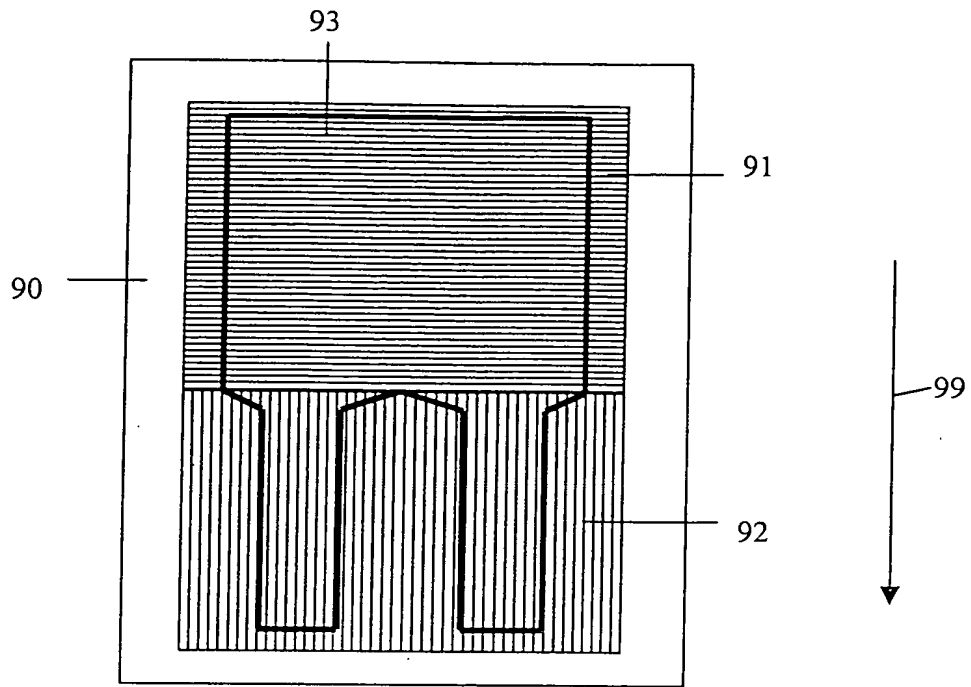


Fig. 9a

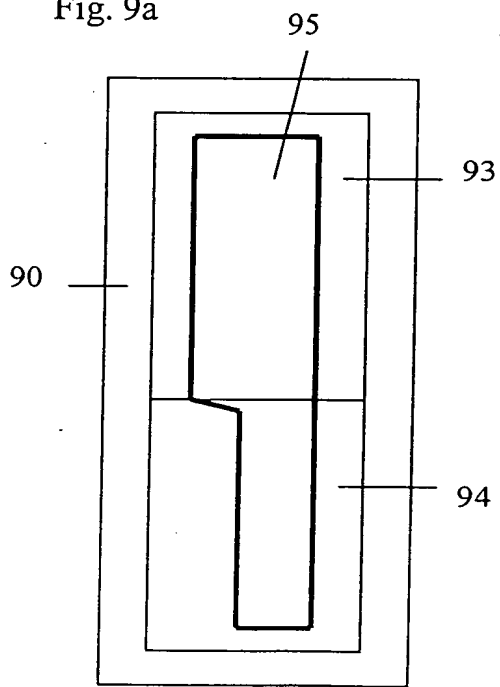


Fig. 9b

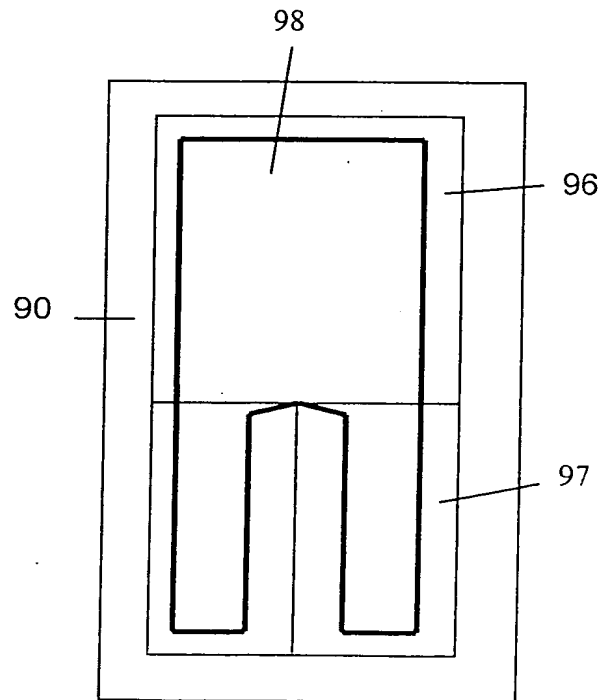


Fig. 9c

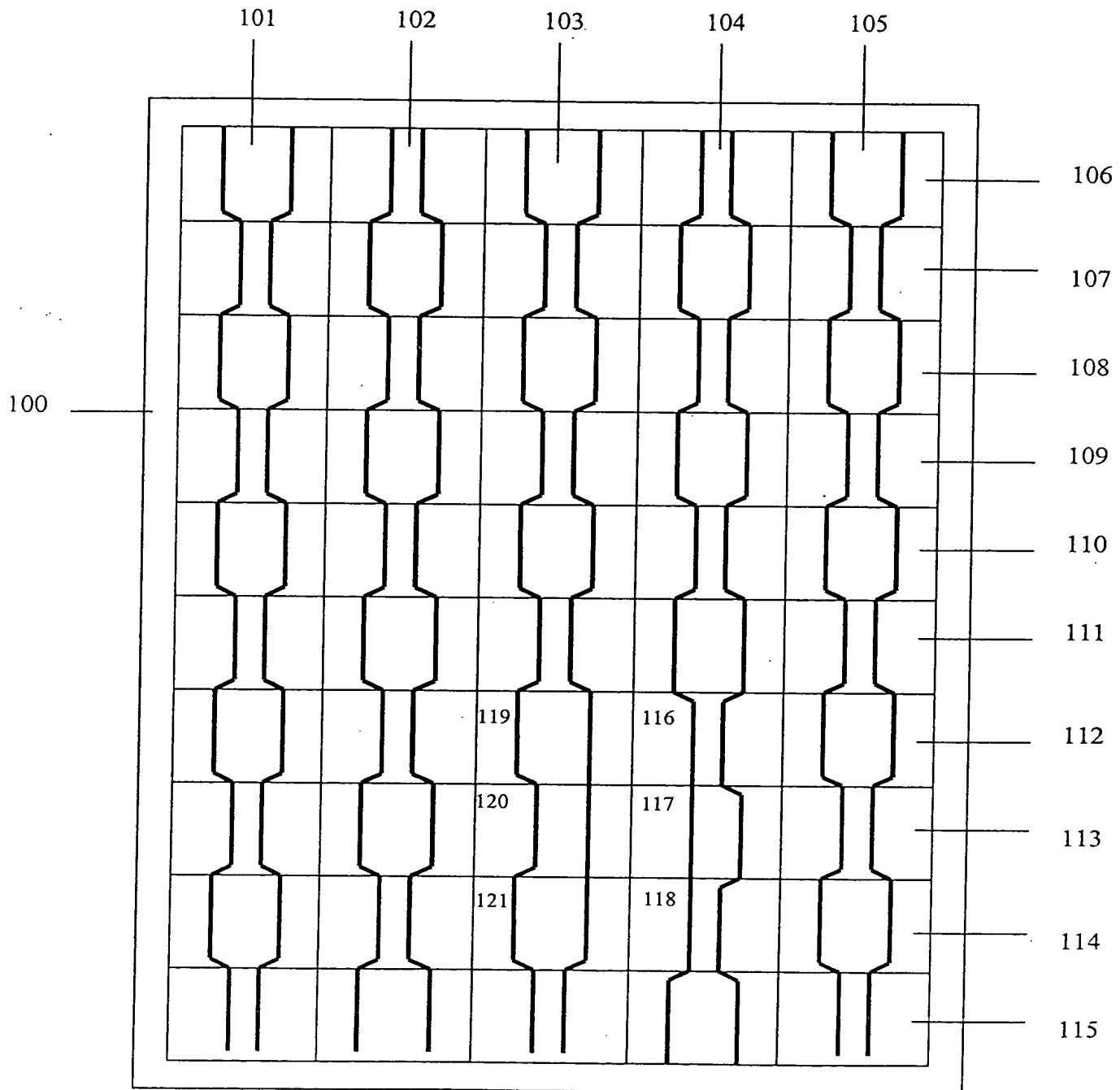


Fig. 10